

智慧財產法院行政判決

109年度行專訴字第15號

原告 廣流智權有限公司

代表人 李文賢（董事）住同上

訴訟代理人 蔡居諭專利師（兼送達代收人）

黃亭穎專利師

翁振耘律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 黃本立

參加人 豪勉科技股份有限公司

代表人 彭以豪（董事長）

訴訟代理人 李易撰律師

許家華律師

上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國109年2月19日經訴字第10906300820號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人於民國102年10月17日以「能提昇檢測效率之點測方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共4項，經被告編為第000000000號審查，准予專利，並發給發明第I541510號專利證書（下稱系爭專利）。後原告以系爭專利有違核准

時專利法（下稱專利法）第22條第2項規定，對之提起舉發。經被告審查，認系爭專利未違反前述專利法規定，以108年8月28日（108）智專三（二）04228字第10820822060號專利舉發審定書為「請求項1至4舉發不成立」的處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經駁回後仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，如訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，命被告就系爭專利為「請求項1至4舉發成立，應予撤銷」之處分。並主張：

（一）原處分對於證據2說明書、晶圓測試技術領域通常知識及原告面詢意見陳述等有利原告之證據，均無調查審究，並漏未斟酌原告全部陳述，違反行政程序法第9、36、43條規定，顯有違誤：

由證據2說明書段落【0042】記載可知，證據2先對全部200個電極之中前100個電極進行第1次評價，再依據第1次評價之探針高度位置，對剩下100個電極進行第2次評價，藉此完成同一片晶圓上數百至數千點的連續檢測。舉上圖為例說明：證據2先檢測一些電極a1至a2後（第1次評價），再對剩下電極a3至a5連續檢測（第2次及隨後評價），亦即，當前a2電極點測程序所獲得之探針位移，用來調整下一次a3電極點測程序之探針位移，以完成同一晶圓上a1至a5電極的連續檢測。詎料，原處分對於證據2說明書【0042】等有利原告之證據，均無調查審究，並漏未斟酌所主張證據2係以當前點測程序所獲得的探針位移來調整下一次進行點測程

01 序時之探針位移的技術手段（藉以完成同一片晶圓上數百至  
02 數千點的連續檢測，而非同一片晶圓完整檢測完後，再重複  
03 檢測數百- 數千次）。

04 （二）原處分解釋系爭專利之專利權範圍增加申請專利範圍所無  
05 限制，違反核准時專利法第58條第4 項規定：

06 1.系爭專利請求項1之解釋：

07 參加人在系爭專利申請審查歷程所提發明專利申復理由書記  
08 載（請參見原處分卷乙證2，第209、206 頁）可徵，參加  
09 人書面自承系爭專利之發明目的及技術重點在於：改良習知  
10 的點測機台僅以壓力參數為調控依據，轉而將檢測到的「壓  
11 力」數據換算為「位移」數據。惟此部分技術內容僅係對應  
12 於系爭專利請求項所載A1-A2、C-D之技術特徵，業經原處  
13 分肯認為系爭專利自承先前技術、證據2至4所揭示。參加  
14 人在系爭專利舉發審查歷程所提發明專利舉發答辯理由書記  
15 載（請參見原處分卷乙證1，第126、120 頁）可徵，參加  
16 人書面自承系爭專利之主要技術及發明特點在於：跳脫了習  
17 知技術僅以當前探針與晶粒間的壓力，決定探針的停止位置  
18 的普遍認知，轉而將本次檢測到的「壓力」數據與「位移量  
19 」數據掛勾。惟此部分技術內容僅係對應於系爭專利請求項  
20 所載A1-A2、C-D之技術特徵，業經原處分肯認為系爭專利  
21 自承先前技術、證據2至4所揭示。準此而言，參加人所在  
22 申請歷史檔案所自承系爭專利之技術重點，僅係對應於系爭  
23 專利請求項所載A1-A2、C-D之技術特徵，此部分業經原處  
24 分肯認為系爭專利自承先前技術、證據2至4所揭示。是系  
25 爭專利相較於先前技術之區別技術特徵在於：量測「位移」  
26 並計算「差異位移值」，據以調整下次點測時序時應帶動承

載台/探針之位移距離，即請求項1所述「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之F技術特徵。

2.證據2揭示系爭專利請求項1之F技術特徵：

參閱證據2說明書【0039】、【0042】記載可知，證據2先對全部200個電極之中前100個電極進行第1次評價，再依據第1次評價之探針高度位置，對剩下100個電極進行第2次評價，藉此完成同一片晶圓上數百-數千點的連續檢測。進一步言，舉本院卷第14頁上圖為例說明：證據2先檢測一些電極a1-a2後，再對剩下電極a3-a5連續檢測，益徵當前a2電極點測程序所獲得之探針位移，用來調整下一次a3電極點測程序之探針位移，以完成同一晶圓上a1-a5電極的連續檢測，是證據2揭示系爭專利請求項1「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵。

3.證據5揭示系爭專利請求項1之F技術特徵：

- (1)由證據5說明書第20頁末行至第21頁第4行上、下文可知，第二或後續被檢查體均是基於最初（第一）被檢查體所獲得的第二上昇量（差異位移值 $\Delta L$ ）來調整後續點測程序之主夾具上昇量。據此，證據5揭示系爭專利請求項1「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之F技術特徵。證據5主張優先權母案為西元2003/06/20之日本0000-000000號公開案，並有相對之美國US0000

000B2 號公告案說明書可佐證其技術內容真意。詳言之，證據5 說明書第20頁末行至第21頁第4 行係對應於美國案US000000B2 第11大欄第12至19行（請參見甲證3-1 ）記載：「可以將上述（e ）中用於第一被檢查對象W 的主夾具11的下降或上升距離，設置為用於第二或後續被檢查對象W 的第二上升量。」益徵，證據5 揭示系爭專利請求項1 「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵。

(2)系爭專利說明書段落【0015】記載可知，系爭專利在點測程序前，也是偵測當前探針對晶粒的壓力值，並即時調整當前探針位置（垂直），目的在於取得並設定系爭專利請求項1 之A2技術特徵所述「理想位移值」，此部分技術手段與「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之F 技術手段分屬點測前後之不同程序，應予辨明。從而，證據5 說明書第17頁第6 行記載步驟（b）所揭露內容僅是關於如何取得並設定系爭專利請求項1 之A2技術特徵所述「理想位移值」，此部分技術內容與「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之F 技術手段，係屬二事，不應混淆。實則，證據5 說明書第20頁末行至第21頁第4 行內容揭露系爭專利請求項1 「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之F 技術手段，已如前述。綜上可知，被告之答

01 辯理由誤解證據5說明書之揭露內容，不足為憑。

02 (3)證據5 說明書第13頁之揭露相當於系爭專利在點測程序前，  
03 須偵測當前探針對晶粒的壓力值，並即時調整當前探針位置  
04 (垂直)，目的在於設定系爭專利請求項1 之A2技術特徵所  
05 述「理想位移值」，在壓力感測裝置產生之偵測訊號與理想  
06 偵測訊號相符的情況下，停止調整承載台之高度，據以取得  
07 「理想位移值」；且查，證據5 之說明書第15頁明確揭露「  
08 檢查前事先測定經原全面的距離 $L_p$ …」益徵，其說明書第13  
09 頁至第15頁之內容均是描述在點測程序前之技術手段，顯然  
10 與開始點測程序後「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使  
11 該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序  
12 時，應帶動該承載台之位移距離」之F 技術手段無關，是參  
13 加人答辯理由並未正確詮釋證據5技術內容，容有誤會。

14 4.證據6揭示系爭專利請求項1之F技術特徵：

15 (1)證據6 第5 圖、說明書第16頁第6 行至第17頁第5 行記載：  
16 「…( k)進行晶片大小份的移動，…測定形成於晶圓W 上的  
17 所有晶片1 的電氣特性。…算出各區域19與探針26間的距離  
18 。藉由如此測定晶圓W 上的複數處並製成測繪圖，可節省測  
19 定各個晶片1 的位置的手續，提昇檢查效率。」、第8 頁第  
20 17至21行記載：「( e)根據該( d)所決定的該晶片與該探針  
21 間的距離，該移動機構沿Z 方向上昇該載置台，使該晶片與  
22 該探針接觸；( f)測定該晶片的電氣特性；( g)進行被檢查  
23 體的測間距份的移動，並藉由反覆進行( e)至( f)，測定次  
24 一晶片。」可知，晶圓W 表面劃分成數個區域19，每個區域  
25 19包含相鄰的多個晶片1 ，使晶圓W 進行「晶片大小份移動  
26 」檢測，透過分區檢測，僅針對各區域19的第一顆晶片1 進

行測定，決定出該晶片與該探針間的距離，並記憶於測繪圖，接著，晶圓W 進行被檢查體的「測間距分移動」檢測，僅依據各區域19中第一顆晶片1 所決定出的前述距離，讓移動機構沿Z 方向上昇該載置台，測定次一晶片的電氣特性，亦即依序測定各區域19中第二顆晶片1 、第三顆晶片1 …依此類推。依據上述說明可知，如上圖所示，在晶圓W 中，虛線繪示每一個區域19視為一「大份」，實線繪示一個實線晶片1 視為一「小份」，據以進行晶片大小份的移動。換言之，將晶圓W 表面區域劃分成數個虛線的區域19，各個大份區域19包含複數個的小份晶片1 。為了提昇檢查效率，證據6 並非逐一檢測每一顆晶片1 ，而是進行「晶片大小份移動」檢測，透過分區檢測，僅針對各區域19的第一顆晶片1 進行測定，接著，晶圓W 進行被檢查體的測間距分移動檢測，僅依據各區域19中第一顆晶片1 所決定出的前述距離，讓移動機構沿Z 方向上昇該載置台，測定次一晶片的電氣特性，亦即依序測定各區域19中第二顆晶片1 、第三顆晶片1 …依此類推。據此，證據6 揭示系爭專利請求項1 「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之F技術特徵。

- (2)證據6 說明書揭露晶圓W 進行大小份的移動，透過分區檢測，僅針對各區域19的第一顆晶片1 進行測定，接著，晶圓W 進行被檢查體的測間距分的移動，僅依據各區域19中第一顆晶片1 所決定出的前述距離，讓移動機構沿Z 方向上昇該載置台，測定次一晶片的電氣特性，亦即依序測定各區域19中第二顆晶片1 、第三顆晶片1 …依此類推。據此，證據6 實

01 已揭示系爭專利請求項1 「將該差異位移值傳送予該驅動裝  
02 置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點  
03 測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之F 技術特徵，是  
04 被告之答辯理由誤解證據6 之揭露內容，尚無足採。參加人  
05 前於系爭專利申請前已公開之另案TZ000000000 說明書第10  
06 頁第14至16行記載：「需特別一提的是，該感測元件21並不  
07 限為應變規，製造廠商亦得以一光學應變計( Optical  
08 Strain Gage)，作為該感測元件21，以偵測該擺臂20的變形  
09 量。」(甲證5 )可知，參加人自承壓力感測技術可變換為  
10 光學感測技術，乃所屬技術領域中具有通常知識者可修飾置  
11 換之慣用手段。

12 (3)自承先前技術、證據2 等並未明確排除將具有壓力感測裝置  
13 的點測探測元件與如證據6 光學測長儀組合，非屬「已明確  
14 排除已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上  
15 係不相容」，而係就系爭專利先前技術相同之技術問題，提  
16 出略不相同之技術手段。詳言之，證據2 揭示「將檢測到的  
17 『壓力』數據換算為『位移』數據，作為調整下次量測探針  
18 / 承載台高度位置之用」，其與證據6 所揭示「將差異位移  
19 值傳送予驅動裝置，作為調整下次量測探針/ 承載台高度位  
20 置」之技術手段相結合後，仍可實現證據2 所述「可防止接  
21 觸所導致的電極破壞」及「提升半導體晶圓之評價可靠度及  
22 效率」等發明目的及功效，況系爭專利請求項1 並未具有無  
23 法預期的功效，僅係自承先前技術、證據2 及證據6 之簡單  
24 置換與組合。

25 5.綜上所述，參加人書面自承系爭專利之發明目的及技術重點  
26 在於改良習知的點測機台僅以壓力參數為調控依據，轉而將

01 檢測到的「壓力」數據換算為「位移」數據，作為調整下次  
02 量測探針/ 承載台高度位置之用，惟證據2 及證據5 已揭示  
03 將「壓力」轉換為「位移」之先前技術內容，且證據2 、證  
04 據5 及證據6 更進一步揭示系爭專利請求項1 之F 技術特徵  
05 已如前述，又前述複數證據間具有明顯的組合動機容後詳述  
06 ，是所屬技術領域中具有通常知識者參酌上開複數證據及申  
07 請前之通常知識，當可輕易完成並證明系爭專利請求項1 不  
08 具進步性。

09 (三) 系爭專利自承先前技術、證據2 及證據3 之組合足證系爭  
10 專利不具進步性：

11 系爭專利自承先前技術、證據2 及證據3 同屬半導體檢測之  
12 技術領域，國際專利分類IPC 均為G01R，技術領域具有關聯  
13 性。系爭專利自承先前技術、證據2 及證據3 均是解決探針  
14 與待測物之間的相對位移不均，導致接觸荷重可能超過允許  
15 值而損傷待測物的問題，所欲解決的問題具有共通性。系爭  
16 專利自承先前技術、證據2 及證據3 均是透過調整探針與待  
17 測裝置之間的相對位移來進行校正，功能或作用具有共通性  
18 。證據2 說明書【0039】、【0046】揭示防止接觸所導致的  
19 電極破壞，以及提升半導體晶圓之評價的可靠度與效率，具  
20 有避免待測元件受到損傷、令點測程序的效率大幅提昇之教  
21 示或建議。準此而言，所屬技術領域中具有通常知識者具有  
22 合理動機將系爭專利自承先前技術、證據2 及證據3 予以組  
23 合，輕易完成請求項1 。況且，自承先前技術、證據2 及證  
24 據3 個別揭示將檢測到的「壓力」數據換算為「位移」數據  
25 ，再將差異位移值傳送予驅動裝置，作為調整下次量測探針  
26 / 承載台高度位置之用，上述先前技術手段相結合後，仍可

實現證據2 所述「可防止接觸所導致的電極破壞」及「提升半導體晶圓之評價可靠度及效率」等發明目的及功效，是系爭專利請求項1 並未具有無法預期的功效，因此能輕易完成而不具進步性。

(四) 系爭專利自承先前技術、證據2 及證據4 之組合足證系爭專利不具進步性：

系爭專利自承先前技術、證據2 及證據4 同屬半導體檢測之技術領域，國際專利分類IPC 均為G01R，技術領域具有關聯性。系爭專利自承先前技術、證據2 及證據4 均是解決探針與待測物之間的相對位移不均，導致接觸荷重可能超過允許值而損傷待測物的問題，所欲解決的問題具有共通性。系爭專利自承先前技術、證據2 及證據4 均是透過調整探針與待測裝置之間的相對位移來進行校正，功能或作用具有共通性。證據2 說明書【0039】、【0046】揭示防止接觸所導致的電極破壞，以及提升半導體晶圓之評價的可靠度與效率，具有避免待測元件受到損傷、令點測程序的效率大幅提昇之教示或建議。準此而言，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機將系爭專利自承先前技術、證據2 及證據4 予以組合，輕易完成請求項1 。況且，自承先前技術、證據2 及證據4 個別揭示將檢測到的「壓力」數據換算為「位移」數據，再將差異位移值傳送予驅動裝置，作為調整下次量測探針/ 承載台高度位置之用，上述先前技術手段相結合後，仍可實現證據2 所述「可防止接觸所導致的電極破壞」及「提升半導體晶圓之評價可靠度及效率」等發明目的及功效，是系爭專利請求項1 並未具有無法預期的功效，因此能輕易完成而不具進步性。

01 (五) 系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4之組合  
02 足證系爭專利不具進步性：

03 系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證據4同屬半導體  
04 體檢測之技術領域，國際專利分類IPC均為G01R，技術領域  
05 具有關聯性。系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證  
06 據4均是解決探針與待測物之間的相對位移不均，導致接觸  
07 荷重可能超過允許值而損傷待測物的問題，所欲解決的問題  
08 具有共通性。系爭專利自承先前技術、證據2、證據3及證  
09 據4均是透過調整探針與待測裝置之間的相對位移來進行校  
10 正，功能或作用具有共通性。證據2說明書【0039】、【00  
11 46】揭示防止接觸所導致的電極破壞，以及提升半導體晶圓  
12 之評價的可靠度與效率，具有避免待測元件受到損傷、令點  
13 測程序的效率大幅提昇之教示或建議。準此而言，所屬技術  
14 領域中具有通常知識者具有合理動機將系爭專利自承先前技  
15 術、證據2、證據3及證據4予以組合，輕易完成請求項1  
16 。況且，自承先前技術、證據2、證據3及證據4個別揭示  
17 將檢測到的「壓力」數據換算為「位移」數據，再將差異位  
18 移值傳送予驅動裝置，作為調整下次量測探針/承載台高度  
19 位置之用，上述先前技術手段相結合後，仍可實現證據2所  
20 述「可防止接觸所導致的電極破壞」及「提升半導體晶圓之  
21 評價可靠度及效率」等發明目的及功效，是系爭專利請求項  
22 1並未具有無法預期的功效，因此能輕易完成而不具進步性  
23 。

24 (六) 系爭專利自承先前技術、證據2及證據5之組合足證系爭  
25 專利不具進步性：

26 系爭專利自承先前技術、證據2及證據5同屬半導體檢測之

技術領域，國際專利分類IPC 均為G01R，技術領域具有關聯性。系爭專利自承先前技術、證據2 及證據5 均是解決探針與待測物之間的相對位移不均，導致接觸荷重可能超過允許值而損傷待測物的問題，所欲解決的問題具有共通性。系爭專利自承先前技術、證據2 及證據5 均是透過調整探針與待測裝置之間的相對位移來進行校正，功能或作用具有共通性。證據2 說明書【0039】、【0046】揭示防止接觸所導致的電極破壞，以及提升半導體晶圓之評價的可靠度與效率，具有避免待測元件受到損傷、令點測程序的效率大幅提昇之教示或建議。準此而言，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機將系爭專利自承先前技術、證據2 及證據5 予以組合，輕易完成請求項1。況且，自承先前技術、證據2 及證據5 個別揭示將檢測到的「壓力」數據換算為「位移」數據，再將差異位移值傳送予驅動裝置，作為調整下次量測探針/ 承載台高度位置之用，上述先前技術手段相結合後，仍可實現證據2 所述「可防止接觸所導致的電極破壞」及「提升半導體晶圓之評價可靠度及效率」等發明目的及功效，是系爭專利請求項1 並未具有無法預期的功效，因此能輕易完成而不具進步性。

（七）系爭專利自承先前技術、證據2 及證據6 之組合足證系爭專利不具進步性：

系爭專利自承先前技術、證據2 及證據6 同屬半導體檢測之技術領域，國際專利分類IPC 均為G01R，技術領域具有關聯性。系爭專利自承先前技術、證據2 及證據6 均是解決探針與待測物之間的相對位移不均，導致接觸荷重可能超過允許值而損傷待測物的問題，所欲解決的問題具有共通性。系爭

專利自承先前技術、證據2 及證據6 均是透過調整探針與待測裝置之間的相對位移來進行校正，功能或作用具有共通性。證據6 第5 圖、說明書第16頁第6 行至第17頁第5 行揭示節省測定各個晶片1 的位置的手續，提昇檢查效率，且證據2 說明書【0039】、【0046】揭示防止接觸所導致的電極破壞，以及提升半導體晶圓之評價的可靠度與效率，具有避免待測元件受到損傷、令點測程序的效率大幅提昇之教示或建議。另外，證據2 說明書段落【0003】記載：「作為使用多接腳之探針的評價裝置，例如有以下方法：以雷射測長儀或光學測長儀檢測探針與載置於載台上之晶圓間的距離，同時使用相機等進行XY方向的對位，藉此在三維的同一坐標上處理探針與晶圓以調節探針的接觸量。」、段落【0045】記載：「例如，上述實施形態中，係列舉使用單探針作為探針而進行半導體晶圓之電特性評價的情況進行說明，但本發明並不限定於此，使用多接腳者作為探針而進行電特性時亦同樣適用。」從而，證據2 之發明可使用多接腳探針的評價裝置，例如：雷射測長儀或光學測長儀，具有結合採用光學反射原理的測長儀來實現其技術內容之教示或建議。由上述說明可知，系爭專利自承先前技術、證據2 及證據6 均屬相同的技術領域、所欲解決的問題具有共通性、在功能或作用上具有共通性、且證據2 提供明確教示或建議結合採用光學反射原理的測長儀來實現其技術內容，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機將自承先前技術、證據2 及證據6 予以組合，輕易完成請求項1。況且，證據2 揭示「將檢測到的『壓力』數據換算為『位移』數據，作為調整下次量測探針/ 承載台高度位置之用」，其與證據6 所揭示「將差異位移

01 值傳送予驅動裝置，作為調整下次量測探針/ 承載台高度位  
02 置」之技術手段相結合後，仍可實現證據2 所述「可防止接  
03 觸所導致的電極破壞」及「提升半導體晶圓之評價可靠度及  
04 效率」等發明目的及功效，是系爭專利請求項1 並未具有無  
05 法預期的功效，因此能輕易完成而不具進步性。

06 三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

07 (一) 原處分第10頁倒數第3 行至第11頁第23行已說明「惟系爭  
08 專利與自承先前技術、證據2 、3 之差異在於，如證據2 第  
09 【0037】- 【0042】，係以當前探針與電極之接觸量，來調  
10 整探針的高度位置，探針會停在接觸量為最佳時的高度位置  
11 ，被調整過的探針高度位置會儲存於記憶手段中，在完整檢  
12 測完後，若同一半導體晶圓需重複二次以上電性評價時，第  
13 二次以後的評價則根據第一次評價所調整的探針高度為基礎  
14 來調整探針高度…是偵測當前探針對晶粒的壓力值，並即時  
15 調整當前探針位置，並未將當前差異位移值，用以調整下一  
16 次點測時探針或承載台的位移距離…未揭示系爭專利請求項  
17 1 「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根  
18 據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承  
19 載台之位移距離」之技術特徵，已載明系爭專利請求項1 與  
20 證據2 第【0037】- 【0042】段技術內容之比對，是以，原  
21 告指稱被告未斟酌全部陳述並說明理由，違反行政程序法第  
22 43條規定之說明理由義務云云，該起訴理由並不可採。

23 (二) 原處分並未將系爭專利限縮解釋為「用以校正晶圓不平整  
24 所造成的探針位移偏差」之發明，經比對證據4 認定系爭專  
25 利之晶圓點測探針校正手段有別於證據4 所揭示的晶圓點測  
26 探針校正手段，如原處分審定書第15頁已記載證據4 (可參考

說明書第7 頁第20行- 第10頁第9 行) 係一種點測裝置的校正方法，如圖1B外迴圈，當結束一晶粒測試而要進行下一晶粒探測時，量測經過的時間或晶圓探測器之相關部件的溫度改變，若需進行新的測量，則進行偏移量之測量，並以此偏移量對一晶粒進行探測，此偏移量是在晶圓探測機任何相關部件之溫度改變大於部分預設值時，由於多種元件之熱膨脹或收縮造成的尺寸改變，晶圓探測機的多種元件之尺寸與這些元件間之距離需進行測量，且多種測量計與工具需要被校正，而系爭專利請求項所載之點測方法，係點測探針接觸到待測元件時，由與探針連接之壓力感測裝置之偵測訊號換算為一實際位移值，並由實際位移值與一理想位移值得到一差異位移值，此差異位移值明顯與證據4 之結束晶粒測試後，感測晶圓探測器因元件之熱膨脹或收縮造成尺寸改變之偏移量不同，且證據4 是測試至少一晶粒後，根據時間或溫度改變，決定是否進行新的量測，系爭專利則是量測壓力值後計算出一差異位移值，並以此調整下一次點測程序之位移距離，故證據4 未揭示系爭專利請求項1 「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」或系爭專利請求項3 「將該差異位移值傳送予該調整裝置，使該調整裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該點測探針之位移距離」之技術特徵」，而審定書所載「…因晶圓不平整而導致探針壓力不同而校正探針位移距離…」僅是用以瞭解系爭專利發明之目的、作用及效果，並未將其讀入申請專利範圍，上述主張及所稱事項係為原告主觀認定，是以該起訴理由並不可採。

01 (三) 系爭專利先前技術、證據2、3之組合不足以證明系爭專  
02 利不具進步性：

03 證據2 第【0037】-【0042】，係以當前探針與電極之接觸  
04 量，來調整探針的高度位置，探針會停在接觸量為最佳時  
05 的高度位置，被調整過的探針高度位置會儲存於記憶手段中，  
06 在完整檢測完後，若同一半導體晶圓需重複二次以上電性評  
07 價時，第二次以後的評價則根據第一次評價所調整的探針高  
08 度為基礎來調整探針高度；另證據3 第13頁第3-16行所揭示  
09 之技術內容是根據當前所監視出的轉力矩，來調整當前探針  
10 的位置，以使探針與電極保持適當的接觸荷重，避免探針卡  
11 或被檢查體的損傷，系爭專利自承先前技術、證據2 及證據  
12 3 皆是偵測當前探針對晶粒的壓力值，並即時調整當前探針  
13 位置，並未將當前差異位移值，用以調整下一次點測時探針  
14 或承載台的位移距離，故系爭專利自承先前技術、證據2 及  
15 證據3 均未揭示系爭專利請求項1 「將該差異位移值傳送予  
16 該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一  
17 次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」或系爭專  
18 利請求項3 「將該差異位移值傳送予該調整裝置，使該調整  
19 裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應  
20 帶動該點測探針之位移距離」之技術特徵，該技術特徵能使  
21 調整裝置適應性地控制該點偵測探針在下一次位移距離，難  
22 謂依系爭專利自承先前技術與證據2、3之組合可輕易完成  
23 ，因此，系爭專利自承先前技術與證據2、3之組合不足以  
24 證明系爭專利請求項1、3 不具進步性。系爭專利請求項2  
25 、4 係分別依附於請求項1、3，均為請求項1、3之進一  
26 步限縮，且包含請求項1、3之所有技術特徵，而系爭專利

01 先前技術、證據2 及證據3 之組合不足以證明系爭專利請求  
02 項1 、3 不具進步性之理由已如前述，故系爭專利先前技術  
03 、證據2 及證據3 之組合亦不足以證明系爭專利請求項2 、  
04 4 不具進步性，是以該起訴理由並不可採。

05 (四) 系爭專利先前技術、證據2 、3 及4 之組合不足以證明系  
06 爭專利不具進步性：

07 證據4(參考說明書第7 頁第20行- 第10頁第9 行) 係一種點  
08 測裝置的校正方法，如圖1B外迴圈，當結束一晶粒測試而要  
09 進行下一晶粒探測時，量測經過的時間或晶圓探測器之相關  
10 部件的溫度改變，若需進行新的測量，則進行偏移量之測量  
11 ，並以此偏移量對一晶粒進行探測，此偏移量是在晶圓探測  
12 機任何相關部件之溫度改變大於部分預設值時，由於多種元  
13 件之熱膨脹或收縮造成的尺寸改變，晶圓探測機的多種元件  
14 之尺寸與這些元件間之距離需進行測量，且多種測量計與工  
15 具需要被校正，而系爭專利請求項所載之點測方法，係點測  
16 探針接觸到待測元件時，由與探針連接之壓力感測裝置之偵  
17 測訊號換算為一實際位移值，並由實際位移值與一理想位移  
18 值得到一差異位移值，此差異位移值明顯與證據4 之結束晶  
19 粒測試後，感測晶圓探測器因元件之熱膨脹或收縮造成尺寸  
20 改變之偏移量不同，且證據4 是測試至少一晶粒後，根據時  
21 間或溫度改變，決定是否進行新的量測，系爭專利則是量測  
22 壓力值後計算出一差異位移值，並以此調整下一次點測程序  
23 之位移距離。故仍未揭示系爭專利請求項1 「將該差異位移  
24 值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，  
25 調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」  
26 或系爭專利請求項3 「將該差異位移值傳送予該調整裝置，

01 使該調整裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程  
02 序時，應帶動該點測探針之位移距離」之技術特徵。」系爭  
03 專利請求項2、4係分別依附於請求項1、3，均為請求項  
04 1、3之進一步限縮，且包含請求項1、3之所有技術特徵  
05 而系爭專利先前技術、證據2、證據3及證據4之組合不  
06 足以證明系爭專利請求項1、3不具進步性之理由已如前述  
07 故系爭專利先前技術、證據2、證據3及證據4之組合亦  
08 不足以證明系爭專利請求項2、4不具進步性，是以該起訴  
09 理由並不可採。

10 (五)系爭專利自承先前技術、證據2、3、4的組合不足證系  
11 爭專利不具進步性如前開理由所述，據此，系爭專利自承先  
12 前技術、證據2與證據4的組合自亦不足證系爭專利不具進  
13 步性，是以該起訴理由並不可採。

14 (六)系爭專利自承先前技術與證據2、5之組合不足以證明系  
15 爭專利不具進步性：

16 1.系爭專利先前技術與證據2未揭露系爭專利請求項1技術特  
17 徵詳如原處分審定書所述，經查證據5一種檢查方法具備：  
18 使用雷射測長機構16來測定載重檢測機構17的負載傳感器17  
19 A的高度；求出從載重檢測機器17的測定位置至與探針12A  
20 的接觸開始點的載重檢測機構17的第一上昇量，使用雷射測  
21 長機構16來測試晶圓W的電極高度，依據晶圓W的電極測定  
22 高度與載重檢測機構17的測定高度的相差來求出電極與探針  
23 12A的接觸開始點為止的主夾具11的第二上昇量。證據5說  
24 明書第18頁第6至14行記載「(e)對準橋13A從探針中心迴  
25 避，藉由主夾具11進行水平移動，將最初須檢查的元件的電  
26 極位於探針卡12的正下方。主夾具11僅上昇第二上昇量，使

得主夾具11上的被檢查體W'的電極P到連接觸開始點。又藉由主夾具僅超越驅動事先所設定的量，被檢查體W'的電極P與探針12A以所定壓力電性地接觸。在該狀態下，被檢查體W'的電性特性被檢查。(f)每當檢查晶圓W上的各被檢查體的電性特性，將晶圓W加以索引移送。然後，藉由實施上述(e)，俾檢查晶圓W上的複數被檢查體的電性特性。

」。

2.系爭專利與自承先前技術、證據2、5之差異在於，如證據2第【0037】-【0042】，係以當前探針與電極之接觸量，來調整探針的高度位置，探針會停在接觸量為最佳時的高度位置，被調整過的探針高度位置會儲存於記憶手段中，在完整檢測完後，若同一半導體晶圓需重複二次以上電性評價時，第二次以後的評價則根據第一次評價所調整的探針高度為基礎來調整探針高度；另查證據5說明書第18頁第6至14行記載「(e)對準橋13A從探針中心迴避，藉由主夾具11進行水平移動，將最初須檢查的元件的電極位於探針卡12的正下方。主夾具11僅上昇第二上昇量，使得主夾具11上的被檢查體W'的電極P到連接觸開始點。又藉由主夾具僅超越驅動事先所設定的量，被檢查體W'的電極P與探針12A以所定壓力電性地接觸。在該狀態下，被檢查體W'的電性特性被檢查。(f)每當檢查晶圓W上的各被檢查體的電性特性，將晶圓W加以索引移送。然後，藉由實施上述(e)，俾檢查晶圓W上的複數被檢查體的電性特性。」另參照證據5說明書第17頁第6行記載步驟(b)可知證據5檢查方法係藉由負載感測器接收壓力訊號，控制裝置的演算處理部判斷接觸點，並由記憶部記憶該高度，系爭專利自承先前技術、證據2及

證據5 皆是偵測當前探針對晶粒的壓力值，並即時調整當前探針位置（垂直），並未將當前差異位移值（水平），用以調整下一次點測時探針或承載台的位移距離，故系爭專利自承先前技術、證據2 及證據5 均未揭示系爭專利請求項1 「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵，該技術特徵能使調整裝置適應性地控制該點偵測探針在下一次位移距離，難謂依系爭專利自承先前技術與證據2 、5 之組合可輕易完成，因此，系爭專利自承先前技術與證據2 、5 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

3.系爭專利請求項3 與請求項1 之差異在於「該治具係定位於該承載台上方，且能被一調整裝置帶動進行上下位移，該治具上設有一點測探針及一壓力感測裝置…」；查系爭專利自承先前技術第【0003】段及圖1 揭示「…該點測裝置1 係定位於一基座10上方，…且該點測探針12被驅動而朝該晶粒14之方向位移的情況下…」，可對應系爭專利請求項3 「該治具係定位於該承載台上方，且能被一調整裝置帶動進行上下位移，該治具上設有一點測探針及一壓力感測裝置…」；如前所述，系爭專利自承先前技術、證據2 及證據5 仍未揭示「將該差異位移值傳送予該調整裝置，使該調整裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該點測探針之位移距離」之技術特徵，因此，系爭專利自承先前技術與證據2 、5 之組合不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。

4.系爭專利請求項2 、4 係分別依附於請求項1 、3 ，均為請

01 求項1、3之進一步限縮，且包含請求項1、3之所有技術  
02 特徵，而系爭專利先前技術、證據2及證據5之組合不足以  
03 證明系爭專利請求項1、3不具進步性之理由已如前述，故  
04 系爭專利先前技術、證據2及證據5之組合亦不足以證明系  
05 爭專利請求項2、4不具進步性。

06 (七)系爭專利自承先前技術與證據2、6之組合不足以證明系  
07 爭專利不具進步性：

08 1.系爭專利先前技術與證據2未揭露系爭專利請求項1技術特  
09 徵詳如原處分審定書所述，經查證據6一種進行形成於晶圓  
10 狀基板W上的被檢查體的電氣特性檢查，具備控制位置計測  
11 手段的探針裝置(100)。此探針裝置具備探針室(29)、配  
12 置於該探針室內，用來載置被檢查體的載置台(6)、沿X，  
13 Y，Z及 $\theta$ 方向移動的移動機構(16)、具有複數探針(26  
14 )，對向該載置台配置的探針卡(14)以及第1光學式測長  
15 器(4a，4b)，該第1光學式測長器照射光線於載置在該載  
16 置台的被檢查體表面，根據其反射光，測定該被檢查體的Z  
17 軸方向位置。證據6說明書第16頁第6行至第17頁第5行記  
18 載「測定晶片1表面的Z方向位置的方法除了使用上述(e)  
19 中的第1光學式測長器4測定各個晶片1的方法外，亦可使  
20 用光學式測長器4，測定晶圓W表面的複數處的Z方向位置  
21 (e1)，製作將晶圓W表面分成幾個區域19的測繪圖(e2)  
22 。測定部位宜為晶圓W上離散的複數點，亦可例如依第5圖  
23 所示，藉由細分晶圓W全面，予以測定，高精度測定晶圓W  
24 的表面波紋。於第5圖中，晶片1上的黑點是第1光學式測  
25 長器測定的候補點。將在此情形下測定的結果記憶於控制裝  
26 置17，控制裝置17可把晶圓W分成幾個區域19，以各個區域

01 19為平面，製成Z 方向位置的測繪圖。控制裝置17根據此測  
02 繪圖，控制載置台6 的上昇距離。控制裝置17於上述( f) 中  
03 比較各區域19的Z 方向位置與所記憶金板13的位置，算出各  
04 區域19與探針26間的距離。藉由如此測定晶圓W 上的複數處  
05 並製成測繪圖，可節省測定各個晶片1 的位置的手續，提昇  
06 檢查效率。」。

07 2.系爭專利與自承先前技術、證據2 、6 之差異在於，如證據  
08 2 第【0037】- 【0042】，係以當前探針與電極之接觸量，  
09 來調整探針的高度位置，探針會停在接觸量為最佳時的高度  
10 位置，被調整過的探針高度位置會儲存於記憶手段中，在完  
11 整檢測完後，若同一半導體晶圓需重複二次以上電性評價時  
12 ，第二次以後的評價則根據第一次評價所調整的探針高度為  
13 基礎來調整探針高度；另查證據6 說明書第16頁第6 行至第  
14 17頁第5 行記載「測定晶片1 表面的Z 方向位置的方法除了  
15 使用上述( e) 中的第1 光學式測長器4 測定各個晶片1 的方  
16 法外，亦可使用光學式測長器4 ，測定晶圓W 表面的複數處  
17 的Z 方向位置( e1) ，製作將晶圓W 表面分成幾個區域19的  
18 測繪圖( e2) 。測定部位宜為晶圓W 上離散的複數點，亦可  
19 例如依第5 圖所示，藉由細分晶圓W 全面，予以測定，高精  
20 度測定晶圓W 的表面波紋。於第5 圖中，晶片1 上的黑點是  
21 第1 光學式測長器測定的候補點。將在此情形下測定的結果  
22 記憶於控制裝置17，控制裝置17可把晶圓W 分成幾個區域19  
23 ，以各個區域19為平面，製成Z 方向位置的測繪圖。控制裝  
24 置17根據此測繪圖，控制載置台6 的上昇距離。控制裝置17  
25 於上述( f) 中比較各區域19的Z 方向位置與所記憶金板13的  
26 位置，算出各區域19與探針26間的距離。藉由如此測定晶圓

W 上的複數處並製成測繪圖，可節省測定各個晶片1 的位置的  
手續，提昇檢查效率。」另參照證據6 說明書第8 頁第17  
-21 行記載，可知證據6 檢查方法係 ( a) 載置晶圓於載置台  
上； ( b)： ( b1) 藉第1 光學式測長器測定附設於該載置台  
的基準面的Z 方向位置； ( b2) 藉由上昇載置台，使基準面  
與探針接觸，測定該基準面與該探針間的距離； ( c) 使用該  
第1 光學式測長器，測定晶片表面的Z 方向位置； ( d) 根據  
上述 ( b) 及 ( c) 的測定結果，決定該晶片表面與該探針前端  
間的距離； ( e) 根據該 ( d) 所決定的該晶片與該探針間的距  
離，該移動機構沿Z 方向上昇該載置台，使該晶片與該探針  
接觸； ( f) 測定該晶片的電氣特性； ( g) 進行被檢查體的測  
間距份的移動，並藉由反覆進行 ( e) 至 ( f)，測定次一晶片  
。證據6 該第1 光學式測長器對形成於載置在該載置台的晶  
圓的晶片表面照射光線，檢測接收其反射光的受光面上的反  
射光的位置，根據其位置，測定該晶片的Z 軸方向的位置，  
並未將當前差異位移值，用以調整下一次點測時探針或承載  
台的位移距離，故系爭專利自承先前技術、證據2 及證據6  
均未揭示系爭專利請求項1 「將該差異位移值傳送予該驅動  
裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行  
點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵，該  
技術特徵能使調整裝置適應性地控制該點偵測探針在下一次  
位移距離，難謂依系爭專利自承先前技術與證據2 、6 之組  
合可輕易完成，因此，系爭專利自承先前技術與證據2 、6  
之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

3. 系爭專利請求項3 ，與系爭專利請求項1 之差異在於「該治  
具係定位於該承載台上方，且能被一調整裝置帶動進行上下

01 位移，該治具上設有一點測探針及一壓力感測裝置…」；查  
02 系爭專利自承先前技術第【0003】段及圖1 揭示「…該點測  
03 裝置1 係定位於一基座10上方，…且該點測探針12被驅動而  
04 朝該晶粒14之方向位移的情況下…」，可對應系爭專利請求  
05 項3 「該治具係定位於該承載台上方，且能被一調整裝置帶  
06 動進行上下位移，該治具上設有一點測探針及一壓力感測裝  
07 置…」；如前所述，系爭專利自承先前技術、證據2 及證據  
08 6 仍未揭示「將該差異位移值傳送予該調整裝置，使該調整  
09 裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應  
10 帶動該點測探針之位移距離」之技術特徵，因此，系爭專利  
11 自承先前技術與證據2 、6 之組合不足以證明系爭專利請求  
12 項3 不具進步性。

13 4.系爭專利請求項2 、4 係分別依附於請求項1 、3 ，為請求  
14 項1 、3 之進一步限縮，且包含請求項1 、3 之所有技術特  
15 徵，而系爭專利先前技術、證據2 及證據6 之組合不足以證  
16 明系爭專利請求項1 、3 不具進步性之理由已如前述，故系  
17 爭專利先前技術、證據2 及證據6 之組合亦不足以證明系爭  
18 專利請求項2 、4 不具進步性。

19 四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

20 (一)系爭專利之技術並非僅能達成說明書第[ 0009] 段所載之  
21 「功效」，該段落所載本發明之另一「目的」，不足以證明  
22 系爭專利採用之「技術」與習知技術間有何近似之處：

23 1.系爭專利說明書第[ 0008] 段已記載本發明之主要目的，且  
24 記載與主要申請專利範圍對應之技術手段，縱說明書第[000  
25 9]段揭示系爭專利亦可應用於「位移距離保持一致」之境  
26 境，亦無理由做出「『僅』適用在表面平整的晶圓檢測上」之

01 結論。

02 2. 蓋發明專利所保護之標的係利用自然法則之技術思想之創作  
03 採用不同技術手段達成相同或更佳的功效，抑或能在更廣  
04 的適用範圍內達成技術目的，皆屬專利法所欲鼓勵及促進之  
05 產業發展方向。舉例而言，汽車的問世，並不因過往以馬車  
06 即可達成載運目的，即喪失其新穎性或進步性。

07 (二) 原處分已針對原告反覆提出之論點進行充分地回應，並未  
08 違反行政程序法第43條及/ 或第9 、36條之規定：

09 原告反覆爭執之內容，被告不但已於處分理由中進行完整論  
10 述，且該等內容早已於面詢過程中被反覆提及、充分辯論，  
11 賦予原告充足地程序保障後被記載於面詢紀錄表第5 頁，實  
12 無理由執此指摘原處分違反行政程序法第43條及/ 或第9 、  
13 36條之規定。

14 (三) 原處分未違反專利法第58條第4 項之規定，原告主觀地將  
15 系爭專利之整體發明，恣意地割裂、肢解為獨立的技術特徵  
16 ，並替換技術概念後與各別證據進行比對，實不足以否定系  
17 爭專利之進步性：

18 1. 原處分依據系爭專利請求項1 、3 所載「……將該差異位移  
19 值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，  
20 調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離…  
21 …」等技術內容認定系爭專利之進步性，而非如原告所稱讀  
22 入「用以校正晶圓不平整所造成的探針位移偏差」等內容後  
23 ，據該等內容認定系爭專利之進步性，是以並未違反專利法  
24 第58條第4 項之規定。

25 2. 系爭專利其中一核心特徵在於，其係根據探針移動一預定距  
26 離時所偵測的壓力訊號，調整「下一次」的移動距離，並非

在點測程序即時動態調整探針高度，原告牽強地割裂相關聯技術特徵，且擅自將部分技術特徵上位化後再進行比對，實已逸脫最廣合理解釋原則之範疇：

( 1) 專利審查基準第二篇第三章「專利要件」，其中第三節「進步性」的「3.3.1 整體審查」中，明確載有「審查進步性時，應以申請專利之發明的整體 (as a whole) 為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵，亦不得僅針對發明與相關先前技術之間的差異本身，判斷該發明是否能被輕易完成。」，強調應以發明的整體為對象，判斷發明是否能被輕易完成，而非恣意將彼此關聯之技術特徵生硬地進行割裂，再逐一、分別找尋有關技術特徵進行比對。

( 2) 原告始終堅持將彼此關聯之技術特徵牽強地割裂，並陳稱系爭專利申請專利範圍僅以文字限定「差異位移值」之物理量云云，試圖將該技術特徵上位化為單純的「位移」，而刻意對申請專利範圍中已明確記載有關「差異位移值」之定義視而不見、置若罔聞；原告復陳稱證據2 已揭露紀錄位移值供後續檢測程序沿用之技術特徵，因此已實質公開系爭專利申請專利範圍所請求保護之內容云云。此外，原告又陳稱有關「…依據相鄰之晶粒表面幅度近似之特點，將『當前( 本次) 』點測探針( 221) 的壓力與『下一次』點測探針( 221) 對相鄰晶粒的位移量掛勾…」等重要的差異技術特徵，僅與原告主觀分類為A1至A2、C 至D 之技術特徵有關，卻未能解釋為何上述特徵與原告主觀分類為F 之「及將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整『下一次』進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」等技術特徵無涉？

( 3 ) 系爭專利申請專利範圍明確載有「在該點測探針接觸到該待測元件的情況下，接收該壓力感測裝置傳來之該偵測訊號」（點測時接收壓力感測訊號）、「根據該換算公式或該對照表，推算出對應的位移距離，以將該偵測訊號換算為一實際位移值；比對該實際位移值及該理想位移值，且獲得該實際位移值及該理想位移值間之一差異位移值」（自前述壓力感測訊號獲得差異位移值）以及「…該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離。」（調整下一次的位移距離）等技術特徵，構成系爭專利與習知技術之主要差異之一。

( 4 ) 由上述說明可知，系爭專利申請專利範圍已明確記載用於調整「下一次」位移距離之該差異位移值係得自「前一次」點測程序中的壓力值，實無理由採原告之見解，硬行將申請專利範圍中對特定名詞所做成之定義與該特定名詞割裂，再擅自賦予該特定名詞新的定義，甚至進一步將「差異位移值」刻意簡化、上位化成單純的「位移」。顯然原告在技術特徵的割裂與比對充斥諸多恣意、主觀的操作，並非妥適。

( 四 ) 原告所提出之該等證據，均未揭示與系爭專利近似之技術內容；此外，原告以有關光學應變規的技術內容，陳稱所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合光學測距儀，顯然係對技術原理的嚴重誤會：

1. 原告所提出之該等證據，均未揭示系爭專利「根據探針移動一預定距離時所偵測的壓力訊號，調整『下一次』的移動距離」等技術特徵，其詳細理由參加人已於109年7月10日行政訴訟參加訴訟狀中詳述，茲不重覆贅述。

2. 有關光學應變規的技術原理，係藉由狹縫繞射的原理，通過

01 偵測物體整體形變的過程中狹縫的變化量推算物體的受力大  
02 小，其本質上確實係與壓力計較為接近；至於原告所提出之  
03 光學測距儀，主要是向待測距的物體發射雷射脈衝並開始計  
04 時，根據接收到反射光的時間判斷發射端與待測物體之間的  
05 距離，兩者無論在技術原理或應用層面上均有顯著差異，實  
06 無理由僅因兩者均有提及「光學」便率然地認為可以彼此代  
07 換。

08 （五）綜上，原告所主張之理由，無非係全然無視發明整體中技  
09 術特徵之間的關聯性，主觀、恣意地割裂系爭專利申請專利  
10 範圍的技術特徵，並且刻意擷取拼湊該等證據的局部技術手  
11 段，強行解釋該等證據對應系爭專利之整體技術特徵，實則  
12 ，系爭專利請求項1-4 相較於原告所提出之該等證據之組合  
13 ，均未違反核准處分時應適用之專利法第22條第2 項之規定  
14 ，具備進步性，原處分及訴願決定尚無違誤，應予維持。

15 五、本院得心證之理由：

16 （一）系爭專利於民國102 年10月17日申請，被告於105 年5 月  
17 31日審定准予專利，故其是否符合專利要件，應以核准審定  
18 時專利法即103 年1 月22日修正公布、103 年3 月24日施行  
19 之專利法為斷。按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可  
20 供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為上開專利法  
21 第21條及第22條第1 項前段所明定。又發明如「為其所屬技  
22 術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成  
23 時」，不得取得專利，復為同法第22條第2 項所明定。而對  
24 於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法規定者，  
25 依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專  
26 利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法

01 應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有  
02 違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

03 (二) 系爭專利技術分析

04 1. 系爭專利技術內容：

05 系爭專利係一種能提昇檢測效率之點測方法，係應用於一點  
06 測機台上，該點測機台包括一承載台、一治具及一控制單元  
07 ；該治具上設有一點測探針及一壓力感測裝置；該承載台上  
08 置放有複數個待測元件（如：LED 之晶粒），且能被一驅動  
09 裝置帶動進行上下位移，使該待測元件與該點測探針相接觸  
10 ；該控制單元係分別與該驅動裝置及該治具相電氣連接，該  
11 點測方法能使該控制單元透過該驅動裝置，令該承載台朝上  
12 位移，且在該點測探針接觸到該待測元件時，接收由該壓力  
13 感測裝置傳來之一偵測訊號；之後，將該偵測訊號換算為一  
14 實際位移值，並將該實際位移值與一理想位移值進行比對，  
15 以獲得一差異位移值；最後，將該差異位移值傳送予該驅動  
16 裝置，如此，由於該點測方法係直接控制驅動裝置之位移距  
17 離，故能確保點測程序之速度與穩定性，提昇點測程序之效  
18 率（參系爭專利摘要）。

19 系爭專利係使用與探針連動之壓力感測裝置來感測探針與待  
20 測元件間的接觸程度，並根據感測裝置的感測值調整承載台  
21 （或探針）位移距離，使探針與待測元件間達到預定的接觸  
22 壓力，將符合該接觸壓力的位移距離設定為一理想位移值，  
23 接著在下一次的量測中令承載台（或探針）移動該理想位移  
24 值並感測其接觸壓力，將該接觸壓力與預定的接觸壓力比較  
25 後計算（或查表）得到一實際位移值，再將實際位移值與理  
26 想位移值比較後得到一差異位移值，驅動裝置即根據該差異

01 位移值修正該理想位移值，再下一次的量測中即使用修正後  
02 的位移值使承載台（或探針）位移，並循環上述修正步驟。  
03 因此系爭專利每一次承載台（或探針）的移動量皆係根據上  
04 一次的移動量及壓力量測結果作修正，為一動態式的調整過  
05 程。

06 2.系爭專利主要圖式如附圖一所示。

07 3.系爭專利申請專利範圍分析：

08 系爭專利申請專利範圍共計4 個請求項，其中請求項1 、3  
09 為獨立項，其餘為附屬項，內容如下：

10 (1)一種能提昇檢測效率之點測方法，係應用於一點測機台上，  
11 該點測機台包括一承載台、一治具及一控制單元，該承載台  
12 上置放有複數個待測元件，且能被一驅動裝置帶動進行上下  
13 位移，該治具係定位於該承載台上方，且設有一點測探針及  
14 一壓力感測裝置，該點測探針與該待測元件間保持有一預定  
15 間距，該壓力感測裝置則與該點測探針相連接，以能偵測出  
16 該點測探針上所承受之壓力大小，並生成一偵測訊號，該控  
17 制單元分別與該壓力感測裝置及該驅動裝置相電氣連接，且  
18 其內儲存有一理想位移值、複數筆位移數據及複數筆偵測數  
19 據，各該偵測數據係分別與各該位移數據相對應，且該等位  
20 移數據及偵測數據能形成一換算公式或一對照表，該點測方  
21 法係使該控制單元能執行下列步驟：令該驅動裝置帶動該承  
22 載台朝上方位移一預定距離；在該點測探針接觸到該待測元  
23 件的情況下，接收該壓力感測裝置傳來之該偵測訊號；根據  
24 該換算公式或該對照表，推算出對應的位移距離，以將該偵  
25 測訊號換算為一實際位移值；比對該實際位移值及該理想位  
26 移值，且獲得該實際位移值及該理想位移值間之一差異位移

01 值；及將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能  
02 根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該  
03 承載台之位移距離。

04 (2) 如請求項1 所述之點測方法，其中該換算公式為一等斜率之  
05 計算式。

06 (3) 一種能提昇檢測效率之點測方法，係應用於一點測機台上，  
07 該點測機台包括一承載台、一治具及一控制單元，該承載台  
08 上置放有複數個待測元件，該治具係定位於該承載台上方，  
09 且能被一調整裝置帶動進行上下位移，該治具上設有一點測  
10 探針及一壓力感測裝置，該點測探針與該待測元件間保持有  
11 一預定間距，該壓力感測裝置則與該點測探針相連接，以能  
12 偵測出該點測探針上所承受之壓力大小，並生成一偵測訊號  
13 ，該控制單元分別與該壓力感測裝置及該調整裝置相電氣連  
14 接，且其內儲存有一理想位移值、複數筆位移數據及複數筆  
15 偵測數據，各該偵測數據係分別與各該位移數據相對應，且  
16 該等位移數據及偵測數據能形成一換算公式或一對照表，該  
17 點測方法係使該控制單元能執行下列步驟：令該調整裝置帶  
18 動該點測探針朝該待測元件之方向位移一預定距離；在該點  
19 測探針接觸到該待測元件的情況下，接收該壓力感測裝置傳  
20 來之該偵測訊號；根據該換算公式或該對照表，推算出對應  
21 的位移距離，以將該偵測訊號換算為一實際位移值；比對該  
22 實際位移值及該理想位移值，且獲得該實際位移值及該理想  
23 位移值間之一差異位移值；及將該差異位移值傳送予該調整  
24 裝置，使該調整裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行  
25 點測程序時，應帶動該點測探針之位移距離。

26 (4) 如請求項3 所述之點測方法，其中該換算公式為一等斜率之

計算式。

### (三) 舉發證據技術分析

1. 證據2 為92年12月5 日公開之日本第0000-000000 號「半導體之工- ハ\$ 評價裝置及 評價方法」發明專利案，公開日早於系爭專利申請日( 102 年10月17日) ，可為系爭專利之先前技術。提供一種評估設備和評估方法，其目的為精確地使探針與電極接觸時具有足夠的接觸量，以準確而簡單地評估半導體晶片的電特性而不會引起誤差。半導體晶片的評估設備係通過使探針與半導體晶片上的電極接觸，再施加電流來量測半導體晶片的電特性。該設備配備有接觸量檢測裝置，該接觸量檢測裝置至少包括用於檢測接觸壓力的應變儀以感測探針與電極的接觸量，該設備另配備有探針位置控制裝置，該探針位置控制裝置基於由接觸量檢測裝置檢測出的探針與電極的接觸量來調整探針的高度位置( 參證據2 摘要) 。其主要圖式詳附圖二所示。

2. 證據3 為98年8 月16日公開之我國第000000000 號「檢查裝置」發明專利案，公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。為一種即使在高溫檢查下探針卡發生熱膨脹時，還是可以適當的接觸荷重來進行檢查之檢查裝置。本發明的檢查裝置( 10) 是具備：可溫度調節的載置台( 11) 、升降驅動機構( 12) 、探針卡( 13) 及控制裝置( 14) 。升降驅動機構( 12) 具備：使載置台( 11) 升降，經由耦合構件( 125A、125B) 來連結的第1 、第2 驅動軸( 123A、123B) 、及使該等的驅動軸( 123A、123B) 驅動的步進馬達(124) 、及在第1 、第2 驅動軸( 123A、123B) 間檢測出根據複數的探針( 13A) 與裝置間的接觸荷重的轉力矩之轉力矩檢出

手段(128)。控制裝置(14)是具有轉力矩控制部(143)，其係根據探針卡(13)隨溫度變化而膨脹時之來自轉力矩檢出手段(128)的轉力矩信號來控制成基準轉力矩(參證據3摘要)。其主要圖式詳附圖三所示。

3.證據4為96年10月1日公開之我國第000000000號「動態探針調整之方法及設備」發明專利案，公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。為在改變條件(例如測試條件或環境條件)時，用於自動地將探針接腳對準至半導體元件之測試或結合墊的改良方法及設備。在至少一實施例中，係使用一動態模型以預測改變條件對晶圓探測流程的影響。此降低在探測與測試期間之頻繁測量與校正之需求，藉此增加在預定期間內可進行探測與測試之晶片數目，且同時增加探測之精確度。本發明之實施例亦使探針接腳與墊在互相接觸時，仍可相應於條件改變而調整位置(參證據4摘要)。其主要圖式詳附圖四所示。

4.證據5(甲證3)為94年3月1日公開之我國第000000000號「檢查被檢查體的電性特性的檢查方法及檢查裝置」發明專利案，公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。為一種檢查方法，具備：使用雷射測長機構(16)來測定載重檢測機構(17)的負載傳感器(17A)的高度；求出從載重檢測機構(17)至與探針(12A)的接觸開始點的主夾具(11)第一上昇量，使用雷射測長機構(16)來測試晶圓W的電極高度，依據晶圓W的電極高度與載重檢測機構(17)的高度差來求出晶圓W電極與探針(12A)的接觸開始點的主夾具(11)的第二上昇量(參證據5摘要)。其主要圖式詳附圖五所示。

01 5.證據6(甲證4)為98年8月21日公告之我國第I313751號「具  
02 備光學式測長器的探針裝置及探針檢查方法」發明專利案，  
03 公開日係早於系爭專利申請日(102年10月17日)，可為系  
04 爭專利之先前技術。為一種檢查晶圓狀基板W上的被檢查體  
05 的電氣特性方法與裝置，具備控制位置手段的探針裝置(100  
06 )。此探針裝置具備探針室(29)、配置於該探針室內，用  
07 來載置被檢查體的載置台(6)、沿X，Y，Z及 $\theta$ 方向移動  
08 的移動機構(16)、具有複數探針(26)，對向該載置台配  
09 置的探針卡(14)以及第1光學式測長器(4a，4b)，該第  
10 1光學式測長器照射光線於載置在該載置台的被檢查體表面  
11 ，根據其反射光，測定該被檢查體的Z軸方向位置。又可具  
12 備第2光學式測長器(5a，5b)(參證據6摘要)。其主要  
13 圖式詳附圖六所示。

14 6.上揭證據5、6及其證據組合，係原告依智慧財產案件審理  
15 法第33條第1項規定，就系爭專利不具進步性之同一撤銷理  
16 由提出之新證據，本院應併予審理。

17 (四)系爭專利自承先前技術、證據2與證據3之組合不足以證  
18 明系爭專利請求項1-4不具進步性：

19 1.系爭專利說明書第[0003]、[0005]段之【先前技術】部  
20 分及圖式第1圖所述「一種習知的點測裝置1，該點測裝置  
21 1係定位於一基座10上方，且包括一固定座11、一點測探針  
22 12及一調整構件13，在一晶粒14被置放於該基座10上，且該  
23 點測探針12被驅動而朝該晶粒14之方向位移的情況下(或該  
24 基座10被驅動而朝該點測探針12的方向位移)，該點測探針  
25 12能對該晶粒14施加一電流」對應於系爭專利請求項1之「  
26 一種能提昇檢測效率之點測方法，係應用於一點測機台上，

01 該點測機台包括一承載台、一治具及一控制單元，該承載台  
02 上置放有複數個待測元件，且能被一驅動裝置帶動進行上下  
03 位移，該治具係定位於該承載台上方，且設有一點測探針…  
04 令該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離」，其中  
05 先前技術之點測裝置(1)對應系爭專利請求項1之點測機台  
06 ，先前技術之基座(10)對應系爭專利請求項1之承載台，  
07 先前技術之調整構件(13)對應系爭專利請求項1之控制單  
08 元，先前技術之點測探針(12)對應系爭專利請求項1之點  
09 測探針；系爭專利說明書第[0005]段之【先前技術】部分  
10 所述「在該點測探針12上增設一壓力感測裝置，該壓力感測  
11 裝置能偵測該點測探針12所承受到的壓力大小，據此，在進  
12 行點測程序時，一旦該壓力感測裝置偵測到的壓力值到達一  
13 預定值，則即會控制該點測探針12停止位移，以避免對該晶  
14 粒14造成損傷」對應於系爭專利請求項1之「一壓力感測裝  
15 置，該點測探針與該待測元件間保持有一預定間距，該壓力  
16 感測裝置則與該點測探針相連接，以能偵測出該點測探針上  
17 所承受之壓力大小，並生成一偵測訊號」。

18 2.證據2說明書第[0024]段及圖1、2所述「本發明的半導  
19 體晶片評估裝置1包括單一類型的探針2和用於檢測探針與  
20 電極之間接觸量的應變儀(未示出)。它包括接觸量檢測裝  
21 置7，和基於檢測到的探針與電極之間的接觸量來調節探針  
22 2高度位置的探針位置控制裝置10」對應於系爭專利請求項  
23 1之「該控制單元分別與該壓力感測裝置及該驅動裝置相電  
24 氣連接」，其中證據2之接觸量檢測裝置(7)對應系爭專利  
25 請求項1之壓力感測裝置，證據2之探針位置控制裝置(10  
26 )對應系爭專利請求項1之控制單元及驅動裝置；證據2說

明書第[ 0041] 段及圖1 、2 所述「在測量電流作為應變儀的輸出值的同時降低探頭的位置，並且該應變儀的輸出值開始顯示出變化…基於應變儀的輸出值與預先存儲在計算機存儲裝置中的探針和電極的接觸量之間的相關性，探針位置控制裝置調整探針的高度位置以調整接觸量…基於與來自應變儀的輸出值與探頭下降量的相關性來檢測探頭的高度位置的結果，檢測出該位置比原點低 $43\mu\text{m}$ ，並儲存在儲存裝置中」對應於系爭專利請求項1 之「其內儲存有一理想位移值、複數筆位移數據及複數筆偵測數據，各該偵測數據係分別與各該位移數據相對應，且該等位移數據及偵測數據能形成一換算公式或一對照表」，其中證據2 之位置比原點低 $43\mu\text{m}$ 對應系爭專利請求項1 之理想位移值，證據2 之應變儀的輸出值對應系爭專利請求項1 之偵測數據，證據2 之探頭下降量對應系爭專利請求項1 之位移數據；證據2 說明書第[0031]段及圖1 、2 所述「使電極16與探針尖端4 進一步接觸（圖2B），此時，可以通過使用具有內置應變計的接觸量檢測裝置7 來檢測探針2 與電極16之間的接觸量，其係測量接觸量檢測裝置7 中的應變儀輸出值，並根據預先獲得的應變儀輸出值以及探針和電極接觸量的關係所得出」對應於系爭專利請求項1 之「在該點測探針接觸到該待測元件的情況下，接收該壓力感測裝置傳來之該偵測訊號；根據該換算公式或該對照表，推算出對應的位移距離，以將該偵測訊號換算為一實際位移值」；證據2 說明書第[ 0030] 段及圖1 、2 揭露「探針量控制裝置10用於通過接觸量檢測裝置7 使附接到臂部3 的探針2 下降」之技術特徵雖與系爭專利請求項1 之「令該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離」不同

，然要使探針與承載台上之待測物接觸，只有移動探針或移動承載台兩種方法，該技術領域中具有通常知識者自能輕易得知可將證據2 之移動探針下降的方法改變成系爭專利請求項1 之移動承載台上升。

3.證據3 說明書第13頁第3 至16行及圖1 所述「轉力矩控制部143 是具有：記憶部，其係記憶複數的探針13A 與複數的電極焊墊最初接觸時在轉力矩檢出器128C所檢測出的轉力矩信號作為基準轉力矩；及偏差計算器，其係計算在之後的檢查時在轉力矩檢出器128C所檢測出之該時間點的轉力矩信號與基準轉力矩信號的差，可將根據偏差計算器的計算結果的轉力矩控制信號傳送至驅動器142，而使步進馬達124 的現在轉力矩收束（退回）至基準轉力矩」對應於系爭專利請求項1 之「比對該實際位移值及該理想位移值，且獲得該實際位移值及該理想位移值間之一差異位移值；及將該差異位移值傳送予該驅動裝置」，其中證據3 之基準轉力矩對應系爭專利請求項1 之理想位移值，證據3 之該時間點的轉力矩對應系爭專利請求項1 之實際位移值，證據3 之計算結果對應系爭專利請求項1 之差異位移值，證據3 之步進馬達對應系爭專利請求項1 之驅動裝置。

4.承上，系爭專利說明書第[ 0005] 段自承之先前技術係在每次下針時都感測探針承受的壓力，並與一固定的預定值做比較來決定當次的探針位置；由證據2 說明書第[ 0015] 、[ 0020] 、[ 0038] 、[ 0039] 段可知，證據2 揭露之技術係經由壓力感測方式調整第一次評估時探針與待測物接觸的高度位置，並將調節後的探針高度位置儲存在儲存裝置中，當進行第二次和隨後的評估時，可以基於在第一次評估中調整

01 的探針高度位置來調整探針的高度位置，亦即第二次和隨後  
02 的評估皆以第一次評估調整後的探針高度位置直接下針，而  
03 不再考慮第二次和隨後評估時下針後量測之應變儀輸出值與  
04 理想值的差異；由證據3 說明書第11至13頁及圖1 可知，證  
05 據3 係經由檢測轉力矩來調整探針與待測物的接觸量，而非  
06 如系爭專利自承之先前技術或證據2 般以壓力值來調整探針  
07 與待測物的接觸量，證據3 之調整方法係將當次下針的實際  
08 轉力矩與第一次下針的轉力矩（基準轉力矩）的差回授給馬  
09 達，用來即時調整當次下針的實際轉力矩，其比較基礎之基  
10 準轉力矩固定為第一次下針的轉力矩，此技術手段與系爭專  
11 利說明書第[ 0005] 段揭露之先前技術中即時監控的技術手  
12 段相似，故系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據3 皆無  
13 揭露系爭專利請求項1 之「使該驅動裝置能根據該差異位移  
14 值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距  
15 離」技術特徵。

- 16 5.原告於行政訴訟起訴理由狀第2 至4 、12頁記載「查證據2  
17 說明書段落【0038】：『當在同一半導體晶圓之電性評價需  
18 重複至少二次時，第一次評價係根據所偵測到之探針與電極  
19 之間的接觸量來調整探針的高度位置，第二次及以後的評價  
20 則可根據於第一次評價時所調整的探針高度來調整探針高度  
21 。』以及段落【0039】：『也就是說，當半導體晶圓的電氣  
22 特性的評價在同一片晶圓至少進行兩次時（舉例而言，需要  
23 測試數百至數千『點』時），在第一次的評價為檢測出探針  
24 和電極的接觸量，然後基於所檢測出的探針和電極的接觸量  
25 調整探針的高度位置，然後對半導體晶圓的電氣特性進行評  
26 價。第二次以後的評價就不是像第一次一樣基於檢測出的探

針和電極的接觸量來調整探針的高度位置。第一次評價中被調整過的探針高度位置會儲存於記憶手段中，然後基於第一次評價的探針高度位置將第二次及以後的探針高度位置調整至與第一次評價的高度位置相同的高度位置（相同的下降量），然後執行電氣特性的評價。』…據此，證據2 揭示系爭專利『將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離』之技術特徵」，以及於109 年8 月18日提出之辯論意旨狀第3 頁記載「惟查證據2 說明書段落【0042】記載：『之後，針對形成於矽晶圓的200 個電極之中的100 個電極，根據如上所述從應變規之輸出值和探針與電極之接觸量的對應關係所檢測的接觸量，藉由探針位置控制機構調節探針之高度位置而進行GOI 評價。再針對剩下100 個電極，以探針位置控制機構進行調節，使探針停在第1 次評價所調節的探針之高度位置、亦即從原點下降43  $\mu\text{m}$  的位置，同樣地進行GOI 評價。』可知，證據2 先對全部200 個電極之中前100 個電極進行第1 次評價，再依據第1 次評價之探針高度位置，對剩下100 個電極進行第2 次評價，藉此完成同一片晶圓上數百至數千點的連續檢測…非如被舉發人所稱係對晶圓上的所有晶粒重複做二次評價」，主張原處分未斟酌全部陳述並說明理由，然根據上述證據2 第[ 0038] 、[ 0039] 及[ 0042] 段之記載，其係記錄第一次評價的探針高度位置，並將第二次及以後的探針高度位置調整至與第一次評價的高度位置相同的高度位置，證據2 所述「第一次評價」與「第二次評價」係指進行待測物檢測程序時下針的時序關係，「第一次評價」泛指下針時序較早的點測程序，「

第二次評價」泛指下針時序較晚的點測程序，因此無論是採「檢測待測物上複數點」或是「單一點檢測複數次」的見解，對解讀證據2 的技術手段並無影響。證據2 非如系爭專利請求項1 係記錄當次下針的探針高度位置與第一次下針的探針高度位置的差值，再以該差值修正下一次下針的探針高度位置，因此證據2 並無揭露系爭專利「將該差異位移值傳送予該驅動裝置，使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵，行政訴訟起訴理由狀第2 至4 、12 頁之記載對證據2 的技術手段顯有誤解。

6. 證據2 在第一次的評價時係使用與系爭專利自承先前技術相似的技術手段，先檢測出探針和電極的接觸量，然後基於所檢測出的探針和電極的接觸量調整探針的高度位置，第二次及以後的評價則可根據於第一次評價時所調整的探針高度來調整探針高度。因此證據2 決定探針高度位置的方法只有兩種：一種是根據壓力值調整當次探針高度位置；一種是將探針高度位置直接設定為一固定值，而系爭專利請求項1 採取的是一種動態的探針高度位置修正方法，其係根據第一次的下針位置決定當次的下針位置，再根據壓力值換算出的位移差異修正下一次的下針位置，證據2 除並無揭露「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵外，該技術領域中具有通常知識者亦無法輕易由證據2 揭露的兩種決定探針位置的方法得知上述系爭專利請求項1 之技術特徵。

7. 綜上，系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據3 皆無揭露系爭專利請求項1 所述「使該驅動裝置能根據該差異位移值

，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵。系爭專利請求項1 並非如證據3 般每次下針進行點測程序時皆修正該次承載台之位移距離，此乃因為修正當次承載台位移距離需量測當次探針的壓力值，並將壓力值傳送至控制單元換算成位移值，再將位移值傳送至控制單元調整探針位移量，雖然能增加當次下針的精確度，但會拖慢整體量測效率，證據2 根據第一次評價的探針高度位置將第二次及以後的探針高度位置調整至與第一次評價的高度位置相同的高度位置，如此便無須每次下針進行點測程序時皆需進行修正程序，然將每次下針皆固定探針高度位置必然造成探針位置精確度下降。系爭專利請求項1 之技術手段為每次下針時皆會記錄差異位移值，並根據該差異位移值修正下一次下針的承載台位移距離，故能達到無須每次下針都須作壓力檢測卻又能即時修正承載台位移距離的功效，故能同時兼顧精確度及檢測效率，因此系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

8. 系爭專利請求項3 與請求項1 不同之處僅在於系爭專利請求項1 係該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離使探針與待測物接觸，而系爭專利請求項3 係該調整裝置帶動該點測探針朝該待測元件之方向位移一預定距離，然證據2 說明書第[ 0030] 段及圖1 、2 已揭露「探針量控制裝置10 用於通過接觸量檢測裝置7 使附接到臂部3 的探針2 下降」之技術手段；系爭專利請求項3 其他技術特徵之比對請參照請求項1 ，故系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據3 之組合不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。系爭專利請求

01 項2 為系爭專利請求項1 之附屬項，包含請求項1 之所有技  
02 術特徵，系爭專利請求項4 為系爭專利請求項3 之附屬項，  
03 包含請求項3 之所有技術特徵，因系爭專利自承之先前技術  
04 、證據2 及證據3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3  
05 不具進步性，故亦無法證明其附屬項2 、4 不具進步性。

06 (五) 系爭專利自承先前技術、證據2 與證據4 之組合不足以證  
07 明系爭專利請求項1-4不具進步性：

08 1.系爭專利說明書第[ 0003] 、[ 0005] 段之【先前技術】部  
09 分及圖式第1 圖所述「一種習知的點測裝置1 ，該點測裝置  
10 1 係定位於一基座10上方，且包括一固定座11、一點測探針  
11 12及一調整構件13，在一晶粒14被置放於該基座10上，且該  
12 點測探針12被驅動而朝該晶粒14之方向位移的情況下( 或該  
13 基座10被驅動而朝該點測探針12的方向位移) ，該點測探針  
14 12能對該晶粒14施加一電流」對應於系爭專利請求項1 之「  
15 一種能提昇檢測效率之點測方法，係應用於一點測機台上，  
16 該點測機台包括一承載台、一治具及一控制單元，該承載台  
17 上置放有複數個待測元件，且能被一驅動裝置帶動進行上下  
18 位移，該治具係定位於該承載台上方，且設有一點測探針…  
19 令該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離」，其中  
20 先前技術之點測裝置( 1) 對應系爭專利請求項1 之點測機台  
21 ，先前技術之基座( 10) 對應系爭專利請求項1 之承載台，  
22 先前技術之調整構件( 13) 對應系爭專利請求項1 之控制單  
23 元，先前技術之點測探針( 12) 對應系爭專利請求項1 之點  
24 測探針；系爭專利說明書第[ 0005] 段之【先前技術】部分  
25 所述「在該點測探針12上增設一壓力感測裝置，該壓力感測  
26 裝置能偵測該點測探針12所承受到的壓力大小，據此，在進

行點測程序時，一旦該壓力感測裝置偵測到的壓力值到達一預定值，即會控制該點測探針12停止位移，以避免對該晶粒14造成損傷」對應於系爭專利請求項1之「一壓力感測裝置，該點測探針與該待測元件間保持有一預定間距，該壓力感測裝置則與該點測探針相連接，以能偵測出該點測探針上所承受之壓力大小，並生成一偵測訊號」。

2.證據2說明書第[0024]段及圖1、2所述「本發明的半導體晶片評估裝置1包括單一類型的探針2和用於檢測探針與電極之間接觸量的應變儀（未示出）。它包括接觸量檢測裝置7，和基於檢測到的探針與電極之間的接觸量來調節探針2高度位置的探針位置控制裝置10」對應於系爭專利請求項1之「該控制單元分別與該壓力感測裝置及該驅動裝置相電氣連接」，其中證據2之接觸量檢測裝置（7）對應系爭專利請求項1之壓力感測裝置，證據2之探針位置控制裝置（10）對應系爭專利請求項1之控制單元及驅動裝置；證據2說明書第[0041]段及圖1、2所述「在測量電流作為應變儀的輸出值的同時降低探頭的位置，並且該應變儀的輸出值開始顯示出變化…基於應變儀的輸出值與預先存儲在計算機存儲裝置中的探針和電極的接觸量之間的相關性，探針位置控制裝置調整探針的高度位置以調整接觸量…基於與來自應變儀的輸出值與探頭下降量的相關性來檢測探頭的高度位置的結果，檢測出該位置比原點低 $43\mu\text{m}$ ，並儲存在儲存裝置中」對應於系爭專利請求項1之「其內儲存有一理想位移值、複數筆位移數據及複數筆偵測數據，各該偵測數據係分別與各該位移數據相對應，且該等位移數據及偵測數據能形成一換算公式或一對照表」，其中證據2之位置比原點低 $43\mu\text{m}$

01 對應系爭專利請求項1 之理想位移值，證據2 之應變儀的輸  
02 出值對應系爭專利請求項1 之偵測數據，證據2 之探頭下降  
03 量對應系爭專利請求項1 之位移數據；證據2 說明書第[003  
04 1]段及圖1 、2 所述「使電極16與探針尖端4 進一步接觸（  
05 圖2B），此時，可以通過使用具有內置應變計的接觸量檢測  
06 裝置7 來檢測探針2 與電極16之間的接觸量，其係測量接觸  
07 量檢測裝置7 中的應變儀輸出值，並根據預先獲得的應變儀  
08 輸出值以及探針和電極接觸量的關係所得出」對應於系爭專  
09 利請求項1 之「在該點測探針接觸到該待測元件的情況下，  
10 接收該壓力感測裝置傳來之該偵測訊號；根據該換算公式或  
11 該對照表，推算出對應的位移距離，以將該偵測訊號換算為  
12 一實際位移值」；證據2 說明書第[ 0030] 段及圖1 、2 揭  
13 露「探針量控制裝置10用於通過接觸量檢測裝置7 使附接到  
14 臂部3 的探針2 下降」之技術特徵雖與系爭專利請求項1 之  
15 「令該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離」不同  
16 ，然要使探針與承載台上之待測物接觸，只有移動探針或移  
17 動承載台兩種方法，該技術領域中具有通常知識者自能輕易  
18 得知可將證據2 之移動探針下降的方法改變成系爭專利請求  
19 項1 之移動承載台上升。

20 3.承上，系爭專利說明書第[ 0005] 段自承之先前技術係在每  
21 次下針時都感測探針承受的壓力，並與一固定的預定值做比  
22 較來決定當次的探針位置；由證據2 說明書第[ 0015] 、[  
23 0020] 、[ 0038] 、[ 0039] 段可知，證據2 揭露之技術係  
24 經由壓力感測方式調整第一次評估時探針與待測物接觸的高  
25 度位置，並將調節後的探針高度位置儲存在儲存裝置中，當  
26 進行第二次和隨後的評估時，可以基於在第一次評估中調整

01 的探針高度位置來調整探針的高度位置，亦即第二次和隨後  
02 的評估皆以第一次評估調整後的探針高度位置直接下針，而  
03 不再考慮第二次和隨後評估下針後量測之應變儀輸出值與理  
04 想值的差異，故系爭專利自承之先前技術及證據2 皆未揭露  
05 系爭專利請求項1 之「使該驅動裝置能根據該差異位移值，  
06 調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」  
07 技術特徵。

08 4. 證據4 說明書第7 至10頁及圖1A、1B所述之技術手段為當動  
09 態地改變條件下，如溫度的大幅改變時，兼顧維持檢測的穩  
10 定性和檢測的效率之間的衡平，如圖1A，一旦晶圓吸座之溫  
11 度改變，需經過足夠之時間( 步驟104)使系統穩定，之後在  
12 探測晶片前，需進行新的測量與校正( 步驟106)，接著，選  
13 擇一晶粒或一組晶片，且根據先前之測量結果來檢測( 步驟  
14 108)，在流程繼續的狀況下，晶圓探測機需要重新校正( 步  
15 驟106)以應付多種材料之熱膨脹或收縮所造成的尺寸改變。  
16 如圖1B，是否需要進行新的測量之決定係根據自最後測量之  
17 經過時間及/ 或根據特定元件自最後測量後之溫度改變，在  
18 方塊138，係量測經過的時間及/ 或晶圓探測機之相關部件  
19 的溫度改變，接著，在方塊140，將這些值與預設值比較，  
20 如果經過之時間長於預設之期間，或如果自最後測量後之任  
21 何相關部件之溫度改變大於部分預設值，則需要接著進行新  
22 的測量。因此，證據4 僅揭露根據最後測量之經過時間及/  
23 或特定元件之溫度改變決定要不要重新量測探針偏移量並校  
24 正，該偏移量係指該輪檢測開始時探針位置與下一輪檢測開  
25 始時探針位置的差異( 外迴圈)，而每輪檢測會下複數次探  
26 針而無須校正( 內迴圈)，由證據4 說明書第8 頁第1、2

01 行「當在每次校正之間的多次探測與測試完成之後，得自最  
02 近測量之參數在下次測量前用於所有後續之探測操作」之內  
03 容可知，其並未將每次下針時探針位置與理想位置的差異值  
04 回傳給系統用以調整下一次下針時的探針位置，故證據4 並  
05 無揭露系爭專利請求項1 之「使該驅動裝置能根據該差異位  
06 移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移  
07 距離」技術特徵。

08 5.原告於行政訴訟起訴理由狀第6 至8 、21頁記載「系爭專利  
09 申請專利範圍並無限定『晶圓不平整』所致差異位移值…探  
10 針位移偏差係由諸多因素所致綜合結果…證據4 實已揭示條  
11 件改變包含『晶圓不平整』」，然根據上述證據4 第7 至10  
12 頁之記載，無論導致晶圓不平整的原因為何，證據4 揭露之  
13 檢測方法流程不變，皆是根據最後測量之經過時間及/ 或特  
14 定元件之溫度改變決定要不要重新量測探針偏移量並校正，  
15 而每輪檢測會下複數次探針而無須校正，因此無論需校正探  
16 針位置的原因為何，證據4 並未將每次下針時探針位置與理  
17 想位置的差異值回傳給系統用以調整下一次下針時的探針位  
18 置，故並無揭露系爭專利請求項1 之「使該驅動裝置能根據  
19 該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載  
20 台之位移距離」技術特徵。

21 6.綜上，系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據4 皆無揭露  
22 系爭專利請求項1 所述「使該驅動裝置能根據該差異位移值  
23 ，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離  
24 」之技術特徵。系爭專利請求項1 因每次下針時皆會記錄差  
25 異位移值，並根據該差異位移值修正下一次下針的承載台位  
26 移距離，故能達到無須每次下針都須作壓力檢測卻又能即時

修正承載台位移距離的效果，因此系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據4 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

7.系爭專利請求項3 與請求項1 不同之處僅在於系爭專利請求項1 係該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離使探針與待測物接觸，而系爭專利請求項3 係該調整裝置帶動該點測探針朝該待測元件之方向位移一預定距離，然證據2 說明書第[ 0030] 段及圖1 、2 已揭露「探針量控制裝置10用於通過接觸量檢測裝置7 使附接到臂部3 的探針2 下降」之技術手段；系爭專利請求項3 其他技術特徵之比對請參照請求項1 ，故系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據4 之組合不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。系爭專利請求項2 為系爭專利請求項1 之附屬項，包含請求項1 之所有技術特徵，系爭專利請求項4 為系爭專利請求項3 之附屬項，包含請求項3 之所有技術特徵，因系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據4 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3 不具進步性，故亦無法證明其附屬項2 、4 不具進步性。

(六)系爭專利自承先前技術、證據2 、證據3 與證據4 之組合不足以證明系爭專利請求項1-4不具進步性：

系爭專利自承先前技術、證據2 與證據3 之組合不足以證明系爭專利請求項1-4 不具進步性請參照爭點1 說明；系爭專利自承先前技術、證據2 與證據4 之組合不足以證明系爭專利請求項1-4 不具進步性請參照爭點2 說明；因系爭專利自承先前技術、證據2 、證據3 與證據4 皆未揭露系爭專利請求項1 之「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」技術特徵，

故系爭專利自承先前技術、證據2、證據3與證據4之組合不足以證明系爭專利請求項1-4不具進步性。

(七) 系爭專利自承先前技術、證據2與證據5之組合不足以證明系爭專利請求項1-4不具進步性：

1. 系爭專利說明書第[0003]、[0005]段之【先前技術】部分及圖式第1圖所述「一種習知的點測裝置1，該點測裝置1係定位於一基座10上方，且包括一固定座11、一點測探針12及一調整構件13，在一晶粒14被置放於該基座10上，且該點測探針12被驅動而朝該晶粒14之方向位移的情況下(或該基座10被驅動而朝該點測探針12的方向位移)，該點測探針12能對該晶粒14施加一電流」對應於系爭專利請求項1之「一種能提昇檢測效率之點測方法，係應用於一點測機台上，該點測機台包括一承載台、一治具及一控制單元，該承載台上置放有複數個待測元件，且能被一驅動裝置帶動進行上下位移，該治具係定位於該承載台上方，且設有一點測探針…令該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離」，其中先前技術之點測裝置(1)對應系爭專利請求項1之點測機台，先前技術之基座(10)對應系爭專利請求項1之承載台，先前技術之調整構件(13)對應系爭專利請求項1之控制單元，先前技術之點測探針(12)對應系爭專利請求項1之點測探針；系爭專利說明書第[0005]段之【先前技術】部分所述「在該點測探針12上增設一壓力感測裝置，該壓力感測裝置能偵測該點測探針12所承受到的壓力大小，據此，在進行點測程序時，一旦該壓力感測裝置偵測到的壓力值到達一預定值，則即會控制該點測探針12停止位移，以避免對該晶粒14造成損傷」對應於系爭專利請求項1之「一壓力感測裝

置，該點測探針與該待測元件間保持有一預定間距，該壓力感測裝置則與該點測探針相連接，以能偵測出該點測探針上所承受之壓力大小，並生成一偵測訊號」。

2.證據2 說明書第[ 0024] 段及圖1 、2 所述「本發明的半導體晶片評估裝置1 包括單一類型的探針2 和用於檢測探針與電極之間接觸量的應變儀（未示出）。它包括接觸量檢測裝置7，和基於檢測到的探針與電極之間的接觸量來調節探針2 高度位置的探針位置控制裝置10」對應於系爭專利請求項1 之「該控制單元分別與該壓力感測裝置及該驅動裝置相電氣連接」，其中證據2 之接觸量檢測裝置（7）對應系爭專利請求項1 之壓力感測裝置，證據2 之探針位置控制裝置（10）對應系爭專利請求項1 之控制單元及驅動裝置；證據2 說明書第[ 0041] 段及圖1 、2 所述「在測量電流作為應變儀的輸出值的同時降低探頭的位置，並且該應變儀的輸出值開始顯示出變化…基於應變儀的輸出值與預先存儲在計算機存儲裝置中的探針和電極的接觸量之間的相關性，探針位置控制裝置調整探針的高度位置以調整接觸量…基於與來自應變儀的輸出值與探頭下降量的相關性來檢測探頭的高度位置的結果，檢測出該位置比原點低 $43\mu\text{m}$ ，並儲存在儲存裝置中」對應於系爭專利請求項1 之「其內儲存有一理想位移值、複數筆位移數據及複數筆偵測數據，各該偵測數據係分別與各該位移數據相對應，且該等位移數據及偵測數據能形成一換算公式或一對照表」，其中證據2 之位置比原點低 $43\mu\text{m}$ 對應系爭專利請求項1 之理想位移值，證據2 之應變儀的輸出值對應系爭專利請求項1 之偵測數據，證據2 之探頭下降量對應系爭專利請求項1 之位移數據；證據2 說明書第[ 00

01 31] 段及圖1、2所述「使電極16與探針尖端4進一步接觸  
02 (圖2B)，此時，可以通過使用具有內置應變計的接觸量檢  
03 測裝置7來檢測探針2與電極16之間的接觸量，其係測量接  
04 觸量檢測裝置7中的應變儀輸出值，並根據預先獲得的應變  
05 儀輸出值以及探針和電極接觸量的關係所得出」對應於系爭  
06 專利請求項1之「在該點測探針接觸到該待測元件的情況下  
07 ，接收該壓力感測裝置傳來之該偵測訊號；根據該換算公式  
08 或該對照表，推算出對應的位移距離，以將該偵測訊號換算  
09 為一實際位移值」；證據2說明書第[0030]段及圖1、2  
10 揭露「探針量控制裝置10用於通過接觸量檢測裝置7使附接  
11 到臂部3的探針2下降」之技術特徵雖與系爭專利請求項1  
12 之「令該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離」不  
13 同，然要使探針與承載台上之待測物接觸，只有移動探針或  
14 移動承載台兩種方法，該技術領域中具有通常知識者自能輕  
15 易得知可將證據2之移動探針下降的方法改變成系爭專利請  
16 求項1之移動承載台上升。

17 3.承上，系爭專利說明書第[0005]段自承之先前技術係在每  
18 次下針時都感測探針承受的壓力，並與一固定的預定值做比  
19 較來決定當次的探針位置；由證據2說明書第[0015]、[  
20 0020]、[0038]、[0039]段可知，證據2揭露之技術係  
21 經由壓力感測方式調整第一次評估時探針與待測物接觸的高  
22 度位置，並將調節後的探針高度位置儲存在儲存裝置中，當  
23 進行第二次和隨後的評估時，可以基於在第一次評估中調整  
24 的探針高度位置來調整探針的高度位置，亦即第二次和隨後  
25 的評估皆以第一次評估調整後的探針高度位置直接下針，而  
26 不再考慮第二次和隨後評估下針後量測之應變儀輸出值與理

想值的差異，故系爭專利自承之先前技術及證據2 皆未揭露系爭專利請求項1 之「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」技術特徵。

4. 證據5 說明書第17、18、20、21頁及圖1、4 所述之技術手段為先以光學方式量測負載傳感器(17A)的表面高度 $L_c$ ；再使探針與負載傳感器接觸，當負載傳感器檢測到的壓力值達到預定值時，測定主夾具(11)的第一上昇量；接著以光學方式量測主夾具上被檢查體 $W'$ 的電極P 的高度 $L_p$ ；藉由 $L_c$ 與 $L_p$ 的差值 $\Delta L$ 修正第一上昇量而得到欲使探針與被檢查體電極達到預定壓力值時主夾具的第二上昇量，如此一來，同時藉由光學與壓力檢測得到主夾具(11)的上昇量。證據5 的 $L_c$ 係指負載傳感器(17A)的表面高度，而系爭專利請求項1 的「理想位移值」係指第一次下針時探針與待測物接觸壓力達預定值時承載台的位移距離，兩者的物理意義並不相同，因此行政訴訟起訴理由狀第30、31頁認為證據5 揭露系爭專利請求項1 之「其內儲存有一理想位移值」之技術特徵容有誤解；同理，證據5 的 $L_p$ 係指被檢查體 $W'$ 的電極P 的高度，而系爭專利請求項1 的「實際位移值」係指根據理想位移值下針後根據檢測到的壓力值換算後得出之承載台位移距離，兩者的物理意義並不相同；證據5 的 $L_c$ 與 $L_p$ 的差值 $\Delta L$ 係指負載傳感器與被檢查體 $W'$ 電極P 的高度差，而系爭專利請求項1 的「差異位移值」係指當次下針承載台實際上應位移距離與第一次下針承載台位移距離的差值，兩者的物理意義並不相同，因此證據5 與系爭專利之技術手段完全不同，證據5 說明書第20、21頁揭露第二次或後續的被檢查對象可使用

第一次被檢查對象的主夾具上昇距離，或者可採用其他預定量，然證據5 並未揭露「其他預定量」係如何測定，故證據5 並無揭露系爭專利請求項1 之「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」技術特徵。

5.原告於109 年7 月15日準備程序提出甲證3-1，其系甲證3（即證據5）的美國對應案，109 年8 月18日提出之辯論意旨狀第9 頁記載由甲證3-1 可佐證證據5 說明書第20頁末行至第21頁第4 行已揭露將用於第一被檢查體W'主夾具( 11) 的下降或上升距離設置為用於第二或後續被W'檢查體，惟該段落揭露之技術手段係直接將第二或後續檢測時的主夾具下降或上升距離設置為與第一次檢測時相同，而非根據第二次檢測與第一次檢測的主夾具下降或上升距離差值去調整第三次檢測的主夾具下降或上升距離，無論證據5 或甲證3-1 皆未揭露系爭專利請求項1 之「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」技術特徵。

6.證據5 的差異值 $\Delta L$  係指負載傳感器與被檢查體W'電極P 的高度差，其物理意義並非系爭專利請求項1 的差異位移值，且證據5 根據差異值 $\Delta L$  得出第二上升量後，接下來的檢測皆以第二上升量作為主夾具移動距離，非如系爭專利請求項1 般每次下針的高度位置會與前次下針的高度位置不同，因此該技術領域中具有通常知識者無法輕易由證據5 揭露的決定探針與晶片位置的方法得知上述系爭專利請求項1 之技術特徵。

7.綜上，系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據5 皆無揭露

01 系爭專利請求項1 所述「使該驅動裝置能根據該差異位移值  
02 調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離  
03 」之技術特徵。系爭專利請求項1 因每次下針時皆會記錄差  
04 異位移值，並根據該差異位移值修正下一次下針的承載台位  
05 移距離，故能達到無須每次下針都須作壓力檢測卻又能即時  
06 修正承載台位移距離的效果，具有不可預期之功效，故系爭  
07 專利自承之先前技術、證據2 及證據5 之組合不足以證明系  
08 爭專利請求項1 不具進步性。

09 8.系爭專利請求項3 與請求項1 不同之處僅在於系爭專利請求  
10 項1 係該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離使探  
11 針與待測物接觸，而系爭專利請求項3 係該調整裝置帶動該  
12 點測探針朝該待測元件之方向位移一預定距離，然證據2 說  
13 明書第[ 0030] 段及圖1 、2 已揭露「探針量控制裝置10用  
14 於通過接觸量檢測裝置7 使附接到臂部3 的探針2 下降」之  
15 技術手段；系爭專利請求項3 其他技術特徵之比對請參照請  
16 求項1 ，故系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據5 之組  
17 合不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。系爭專利請求  
18 項2 為系爭專利請求項1 之附屬項，包含請求項1 之所有技  
19 術特徵，系爭專利請求項4 為系爭專利請求項3 之附屬項，  
20 包含請求項3 之所有技術特徵，因系爭專利自承之先前技術  
21 、證據2 及證據5 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3  
22 不具進步性，故亦無法證明其附屬項2 、4 不具進步性。

23 (八)系爭專利自承先前技術、證據2 與證據6 之組合不足以證  
24 明系爭專利請求項1-4不具進步性：

25 1.系爭專利說明書第[ 0003] 、[ 0005] 段之【先前技術】部  
26 分及圖式第1 圖所述「一種習知的點測裝置1 ，該點測裝置

01 1 係定位於一基座10上方，且包括一固定座11、一點測探針  
02 12及一調整構件13，在一晶粒14被置放於該基座10上，且該  
03 點測探針12被驅動而朝該晶粒14之方向位移的情況下（或該  
04 基座10被驅動而朝該點測探針12的方向位移），該點測探針  
05 12能對該晶粒14施加一電流」對應於系爭專利請求項1 之「  
06 一種能提昇檢測效率之點測方法，係應用於一點測機台上，  
07 該點測機台包括一承載台、一治具及一控制單元，該承載台  
08 上置放有複數個待測元件，且能被一驅動裝置帶動進行上下  
09 位移，該治具係定位於該承載台上方，且設有一點測探針…  
10 令該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離」，其中  
11 先前技術之點測裝置（1）對應系爭專利請求項1 之點測機台  
12 ，先前技術之基座（10）對應系爭專利請求項1 之承載台，  
13 先前技術之調整構件（13）對應系爭專利請求項1 之控制單  
14 元，先前技術之點測探針（12）對應系爭專利請求項1 之點  
15 測探針；系爭專利說明書第[ 0005] 段之【先前技術】部分  
16 所述「在該點測探針12上增設一壓力感測裝置，該壓力感測  
17 裝置能偵測該點測探針12所承受到的壓力大小，據此，在進  
18 行點測程序時，一旦該壓力感測裝置偵測到的壓力值到達一  
19 預定值，則即會控制該點測探針12停止位移，以避免對該晶  
20 粒14造成損傷」對應於系爭專利請求項1 之「一壓力感測裝  
21 置，該點測探針與該待測元件間保持有一預定間距，該壓力  
22 感測裝置則與該點測探針相連接，以能偵測出該點測探針上  
23 所承受之壓力大小，並生成一偵測訊號」。

24 2. 證據2 說明書第[ 0024] 段及圖1 、2 所述「本發明的半導  
25 體晶片評估裝置1 包括單一類型的探針2 和用於檢測探針與  
26 電極之間接觸量的應變儀（未示出）。它包括接觸量檢測裝

置7，和基於檢測到的探針與電極之間的接觸量來調節探針  
2 高度位置的探針位置控制裝置10」對應於系爭專利請求項  
1 之「該控制單元分別與該壓力感測裝置及該驅動裝置相電  
氣連接」，其中證據2 之接觸量檢測裝置(7)對應系爭專利  
請求項1 之壓力感測裝置，證據2 之探針位置控制裝置(10  
) 對應系爭專利請求項1 之控制單元及驅動裝置；證據2 說  
明書第[0041]段及圖1、2 所述「在測量電流作為應變儀  
的輸出值的同時降低探頭的位置，並且該應變儀的輸出值開  
始顯示出變化…基於應變儀的輸出值與預先存儲在計算機存  
儲裝置中的探針和電極的接觸量之間的相關性，探針位置控  
制裝置調整探針的高度位置以調整接觸量…基於與來自應變  
儀的輸出值與探頭下降量的相關性來檢測探頭的高度位置的  
結果，檢測出該位置比原點低 $43\mu\text{m}$ ，並儲存在儲存裝置中  
」對應於系爭專利請求項1 之「其內儲存有一理想位移值、  
複數筆位移數據及複數筆偵測數據，各該偵測數據係分別與  
各該位移數據相對應，且該等位移數據及偵測數據能形成一  
換算公式或一對照表」，其中證據2 之位置比原點低 $43\mu\text{m}$   
對應系爭專利請求項1 之理想位移值，證據2 之應變儀的輸  
出值對應系爭專利請求項1 之偵測數據，證據2 之探頭下降  
量對應系爭專利請求項1 之位移數據；證據2 說明書第[003  
1]段及圖1、2 所述「使電極16與探針尖端4 進一步接觸（  
圖2B），此時，可以通過使用具有內置應變計的接觸量檢測  
裝置7 來檢測探針2 與電極16之間的接觸量，其係測量接觸  
量檢測裝置7 中的應變儀輸出值，並根據預先獲得的應變儀  
輸出值以及探針和電極接觸量的關係所得出」對應於系爭專  
利請求項1 之「在該點測探針接觸到該待測元件的情況下，

01 接收該壓力感測裝置傳來之該偵測訊號；根據該換算公式或  
02 該對照表，推算出對應的位移距離，以將該偵測訊號換算為  
03 一實際位移值」；證據2 說明書第[ 0030] 段及圖1 、2 揭  
04 露「探針量控制裝置10用於通過接觸量檢測裝置7 使附接到  
05 臂部3 的探針2 下降」之技術特徵雖與系爭專利請求項1 之  
06 「令該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離」不同  
07 ，然要使探針與承載台上之待測物接觸，只有移動探針或移  
08 動承載台兩種方法，該技術領域中具有通常知識者自能輕易  
09 得知可將證據2 之移動探針下降的方法改變成系爭專利請求  
10 項1 之移動承載台上升。

11 3.承上，系爭專利說明書第[ 0005] 段自承之先前技術係在每  
12 次下針時都感測探針承受的壓力，並與一固定的預定值做比  
13 較來決定當次的探針位置；由證據2 說明書第[ 0015] 、[  
14 0020] 、[ 0038] 、[ 0039] 段可知，證據2 揭露之技術係  
15 經由壓力感測方式調整第一次評估時探針與待測物接觸的高  
16 度位置，並將調節後的探針高度位置儲存在儲存裝置中，當  
17 進行第二次和隨後的評估時，可以基於在第一次評估中調整  
18 的探針高度位置來調整探針的高度位置，亦即第二次和隨後  
19 的評估皆以第一次評估調整後的探針高度位置直接下針，而  
20 不再考慮第二次和隨後評估下針後量測之應變儀輸出值與理  
21 想值的差異，故系爭專利自承之先前技術及證據2 皆未揭露  
22 系爭專利請求項1 之「使該驅動裝置能根據該差異位移值，  
23 調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」  
24 技術特徵。

25 4.由證據6 說明書第15至18頁及圖1 、4 、5 可知證據6 與證  
26 據5 技術手段相似，皆為先以光學方式量測基準面( 金板)

( 13) 的位置；再使探針與金板接觸，測定載置台 ( 6) 的上昇距離；接著以光學方式量測晶片的位置；藉由金板位置與晶片位置修正載置台的上昇距離使晶片接觸探針，因此證據 6 中金板位置、晶片位置與兩者差值的物理意義與系爭專利請求項 1 之理想位移值、實際位移值與差異位移值完全不同；證據 6 說明書第 16、17 頁及圖 5 記載「測定晶圓 W 表面的複數處的 Z 方向位置 ( e1) ，製作將晶圓 W 表面分成幾個區域 19 的測繪圖 ( e2) 。測定部位宜為晶圓 W 上離散的複數點…控制裝置 17 可把晶圓 W 分成幾個區域 19，以各個區域 19 為平面，製成 Z 方向位置的測繪圖。控制裝置 17 根據此測繪圖，控制載置台 6 的上昇距離。控制裝置 17 於上述 ( f) 中比較各區域 19 的 Z 方向位置與所記憶金板 13 的位置，算出各區域 19 與探針 26 間的距離」，係揭露將晶圓 W 劃分為複數區域 ( 19) ，對每個區域的候補點以光學方法量測探針 ( 26) 與晶圓的距離，因此每個區域量測出的距離有可能不相同，故由此計算出量測不同區域時的載置台上升量亦不相同，然此技術手段仍為將一開始的量測結果 ( 候補點量測結果) 作為基準套用至該區域所有其他晶片的量測上，並非每一次量測都以前一次量測的結果作修正，再將該修正使用在下一次的量測上；故證據 6 並無揭露系爭專利請求項 1 之「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」技術特徵。

5. 證據 6 雖揭露將晶圓分隔為不同區域，於量測到下一個區域時重新校正探針與晶圓的距離，然證據 6 於同一區域中的複數量測點並未修正，因此證據 6 並非每一次量測都以前一次量測的結果作修正，且證據 6 的修正方式係藉由金板位置與晶

片位置的差異值修正載置台的上昇距離，非如系爭專利請求項1 般係以當次下針的實際位移值與理想位移值的差值修正下次下針的高度位置，因此該技術領域中具有通常知識者無法輕易由證據6 揭露的決定探針與晶片位置的方法得知上述系爭專利請求項1 之技術特徵。

6. 綜上，系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據6 皆無揭露系爭專利請求項1 所述「使該驅動裝置能根據該差異位移值，調整下一次進行點測程序時，應帶動該承載台之位移距離」之技術特徵。系爭專利請求項1 因每次下針時皆會記錄差異位移值，並根據該差異位移值修正下一次下針的承載台位移距離，故能達到無須每次下針都須作壓力檢測卻又能即時修正承載台位移距離的效果，具有不可預期之功效，故系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據6 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

7. 系爭專利請求項3 與請求項1 不同之處僅在於系爭專利請求項1 係該驅動裝置帶動該承載台朝上方位移一預定距離使探針與待測物接觸，而系爭專利請求項3 係該調整裝置帶動該點測探針朝該待測元件之方向位移一預定距離，然證據2 說明書第[ 0030] 段及圖1 、2 已揭露「探針量控制裝置10 用於通過接觸量檢測裝置7 使附接到臂部3 的探針2 下降」之技術手段；系爭專利請求項3 其他技術特徵之比對請參照請求項1 ，故系爭專利自承之先前技術、證據2 及證據6 之組合不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。系爭專利請求項2 為系爭專利請求項1 之附屬項，包含請求項1 之所有技術特徵，系爭專利請求項4 為系爭專利請求項3 之附屬項，包含請求項3 之所有技術特徵，因系爭專利自承之先前技術

01       、證據2 及證據6 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3  
02       不具進步性，故亦無法證明其附屬項2 、4 不具進步性。

03       （九）末查原處分已針對原告提出之論點進行回應說明，並無原  
04       告所稱漏未斟酌其全部陳述，違反行政程序法第9 、36、43  
05       條規定情事。且審定書所載「…因晶圓不平整而導致探針壓  
06       力不同而校正探針位移距離…」，僅是用以瞭解系爭專利發  
07       明之目的、作用及效果，並未將其讀入系爭專利申請專利範  
08       圍，而增加申請專利範圍所無限制，原告稱原處分違反核准  
09       時專利法第58條第4 項規定云云，亦無可採。

10       六、綜上所述，原告於舉發階段所提證據組合及於本院所提新證  
11       據組合，均不能證明系爭專利請求項1-4 不具進步性，從而  
12       ，被告所為舉發不成立之處分，即無不合。訴願決定予以維  
13       持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告  
14       就系爭專利舉發案作成舉發成立撤銷專利權之處分，為無理  
15       由，應予駁回。

16       七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，於本  
17       件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

18       據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第  
19       1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

20       中       華       民       國       109       年       9       月       10       日

21                               智慧財產法院第一庭

22                               審判長法   官   李維心

23                               法   官   蔡如琪

24                               法   官   陳忠行

25       以上正本係照原本作成。

26       如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

| 得不委任律師為訴訟代理人之情形                         | 所需要件                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人               | 1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。<br>2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。<br>3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 |
| (二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 | 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。<br>2.稅務行政事件，具備會計師資格者。<br>3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。<br>4.上訴人為公法人、中央或地方機關              |

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10

|                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                     | 、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 |
| 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。 |                                             |

中 華 民 國 109 年 9 月 15 日  
書記官 鄭郁萱